

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/003525

International filing date: 02 March 2005 (02.03.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2004-059402
Filing date: 03 March 2004 (03.03.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 12 May 2005 (12.05.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

11. 3. 2005

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application: 2 0 0 4 年 3 月 3 日

出 願 番 号
Application Number: 特 願 2 0 0 4 - 0 5 9 4 0 2

パリ条約による外国への出願
に用いる優先権の主張の基礎
となる出願の国コードと出願
番号

The country code and number
of your priority application,
to be used for filing abroad
under the Paris Convention, is

J P 2 0 0 4 - 0 5 9 4 0 2

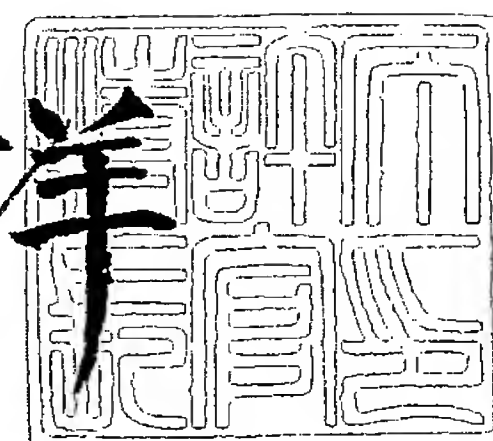
出 願 人
Applicant(s):

株式会社国際電気通信基礎技術研究所
岡山県

2 0 0 5 年 4 月 1 9 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川 洋



【書類名】 特許願
【整理番号】 DAT04001
【提出日】 平成16年 3月 3日
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際特許分類】 G01C 19/66
H01S 3/08

【発明者】
【住所又は居所】 京都府相楽郡精華町光台二丁目 2 番地 2 株式会社国際電気通信
基礎技術研究所内
【氏名】 原山 卓久

【発明者】
【住所又は居所】 岡山県総社市窪木 1 1 1 番地 岡山県立大学内
【氏名】 福嶋 丈浩

【特許出願人】
【識別番号】 393031586
【氏名又は名称】 株式会社国際電気通信基礎技術研究所

【特許出願人】
【識別番号】 591060980
【氏名又は名称】 岡山県

【代理人】
【識別番号】 100107641
【弁理士】
【氏名又は名称】 鎌田 耕一
【電話番号】 06-6316-8750

【選任した代理人】
【識別番号】 100115152
【弁理士】
【氏名又は名称】 黒田 茂

【国等の委託研究の成果に係る記載事項】 平成 1 5 年度通信・放送機構、研究テーマ「
自律分散型無線ネットワークの研究開発」に関する委託研究、産
業活力再生特別措置法第 3 0 条の適用を受ける特許出願

【手数料の表示】
【予納台帳番号】 226219
【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】
【物件名】 特許請求の範囲 1
【物件名】 明細書 1
【物件名】 図面 1
【物件名】 要約書 1
【物件名】 委任状 1
【援用の表示】 平成 1 6 年 2 月 2 5 日提出の包括委任状

【書類名】 特許請求の範囲

【請求項 1】

第 1 および第 2 のレーザ光を出射する半導体レーザと光検出器とを備える半導体レーザジャイロであって、

前記光検出器は、前記第 1 および第 2 のレーザ光によって干渉縞が形成される位置に配置されており、

前記半導体レーザは、活性層と前記活性層にキャリアを注入するための第 1 および第 2 の電極とを備え、

前記第 1 のレーザ光は、前記活性層内において多角形の経路上を周回するレーザ光 (L 1) の一部が出射されたレーザ光であり、

前記第 2 のレーザ光は、前記経路上を前記レーザ光 (L 1) とは逆の方向に周回するレーザ光 (L 2) の一部が出射されたレーザ光である半導体レーザジャイロ。

【請求項 2】

前記活性層の平面形状が環状ではない請求項 1 に記載の半導体レーザジャイロ。

【請求項 3】

前記多角形の経路は菱形の経路であり、

前記活性層は、前記菱形の経路の第 1 から第 4 の角部に対応する位置に形成された第 1 から第 4 の端面を有する請求項 1 または 2 に記載の半導体レーザジャイロ。

【請求項 4】

前記第 1 および第 2 の電極から選ばれる少なくとも 1 つの電極と前記半導体レーザを構成する半導体層とが、前記菱形の経路に沿って接触する請求項 3 に記載の半導体レーザジャイロ。

【請求項 5】

前記菱形の経路の対向する前記第 1 および第 2 の角部の内角は、前記第 3 および第 4 の角部の内角よりも角度が小さく、

前記第 1 および第 2 のレーザ光はともに前記第 1 の角部に対応する位置に形成された前記第 1 の端面から出射される請求項 3 に記載の半導体レーザジャイロ。

【請求項 6】

前記第 1 の角部と前記第 2 の角部とを結ぶ対角線と、前記第 1 および第 2 のレーザとが非平行である請求項 5 に記載の半導体レーザジャイロ。

【請求項 7】

前記活性層は、前記レーザ光 (L 1) および前記レーザ光 (L 2) が前記第 3 および第 4 の端面において全反射する条件を満たす請求項 5 に記載の半導体レーザジャイロ。

【請求項 8】

前記第 1 および第 2 の端面は、それぞれ、外側に凸の曲面である請求項 5 に記載の半導体レーザジャイロ。

【請求項 9】

前記活性層は、前記菱形の経路を含む第 1 の領域と、前記第 1 の領域に隣接する第 2 の領域とを含み、

前記第 1 の領域の平面形状は長方形の短辺を外側に凸の曲面とした形状である請求項 8 に記載の半導体レーザジャイロ。

【請求項 10】

前記第 1 の領域と前記第 2 の領域とによって構成される前記活性層の平面形状が略 H 字状である請求項 9 に記載の半導体レーザジャイロ。

【請求項 11】

前記第 1 の角部と前記第 2 の角部とを結ぶ対角線に平行な方向における前記第 2 の領域の長さ L_s (μm) と、前記第 1 の角部と前記第 2 の角部との距離 L (μm) とが、 $L/4 < L_s$ を満たす請求項 10 に記載の半導体レーザジャイロ。

【請求項 12】

前記光検出器が複数の受光素子を備える請求項 1 ～ 11 のいずれか 1 項に記載の半導体

レーザジャイロ。

【請求項 1 3】

前記半導体レーザと前記光検出器とが、モノリシックに形成されている請求項 1 ～ 1 2 のいずれか 1 項に記載の半導体レーザジャイロ。

【請求項 1 4】

前記半導体レーザと前記光検出器とが同じ積層構造を有する請求項 1 3 に記載の半導体レーザジャイロ。

【請求項 1 5】

レンズをさらに備え、

前記光検出器は、前記レンズを透過した前記第 1 および第 2 のレーザ光によって干渉縞が形成される位置に配置されている請求項 1 ～ 1 2 のいずれか 1 項に記載の半導体レーザジャイロ。

【請求項 1 6】

前記半導体レーザと前記レンズとがモノリシックに形成されている請求項 1 5 に記載の半導体レーザジャイロ。

【請求項 1 7】

前記半導体レーザの半導体層と前記レンズとが同じ積層構造を有する請求項 1 6 に記載の半導体レーザジャイロ。

【請求項 1 8】

プリズムをさらに備え、

前記光検出器は、前記プリズムを透過した前記第 1 および第 2 のレーザ光によって干渉縞が形成される位置に配置されている請求項 1 ～ 1 2 のいずれか 1 項に記載の半導体レーザジャイロ。

【請求項 1 9】

前記半導体レーザと前記プリズムとがモノリシックに形成されている請求項 1 8 に記載の半導体レーザジャイロ。

【請求項 2 0】

前記半導体レーザの半導体層と前記プリズムとが同じ積層構造を有する請求項 1 9 に記載の半導体レーザジャイロ。

【請求項 2 1】

前記半導体レーザと前記プリズムと前記光検出器とがモノリシックに形成されている請求項 1 8 に記載の半導体レーザジャイロ。

【請求項 2 2】

前記半導体レーザの半導体層と前記プリズムと前記光検出器の半導体層とが同じ積層構造を有する請求項 2 1 に記載の半導体レーザジャイロ。

【書類名】明細書

【発明の名称】半導体レーザジャイロ

【技術分野】

【0 0 0 1】

本発明は、半導体レーザを用いたジャイロに関する。

【背景技術】

【0 0 0 2】

回転する物体の角速度を検出するためのジャイロの中でも、光ジャイロは精度が高いという特徴を有する。光ジャイロでは、環状の光路を互いに逆方向に進む2つのレーザ光の周波数差を用いて角速度の検出を行う。このような光ジャイロとして、希ガスレーザを用いた光ジャイロが提案されている（たとえば特許文献1参照）。これらの光ジャイロでは、同じ経路を互いに逆方向に周回するレーザ光を取り出して干渉縞を形成させる。これらの光ジャイロの一般的な構成を図16に示す。図16の光ジャイロにおいて、干渉縞は、以下の式（1）で表される。

【0 0 0 3】

【数1】

$$I = I_0 \left[1 + \cos \left(\frac{2\pi \epsilon \chi}{\lambda} + 2\pi \Delta \omega t + \phi \right) \right] \cdots (1)$$

【0 0 0 4】

ここで、 I_0 はレーザ光の光強度であり、 λ はレーザ光の波長である。また、 ϵ は図16に示す角度であり、 χ は図16に示すX方向の座標である。 $\Delta \omega$ は、ジャイロが回転したときの時計回りのモードと反時計回りのモードとの周波数差であり、 t は時刻である。 $\Delta \omega$ はジャイロの回転の角速度 Ω と比例関係にある。すなわち、 $\Delta \omega = 4 A \Omega / (L \lambda)$ である。ここで、 A はリング形状の囲む面積であり、 L は光路長である。 ϕ は、2つのレーザ光の初期の位相差を示す。このジャイロでは、干渉縞の移動速度および移動方向を検出することによって、ジャイロの回転速度および回転方向が検出される。しかし、希ガスレーザを用いた光ジャイロは、駆動に高電圧が必要で消費電力が大きいという課題、および、装置が大きく熱に弱いという課題を有していた。

【0 0 0 5】

このような課題を解決するジャイロとして、環状の導波路を備える半導体リングレーザを用いたジャイロが提案されている（たとえば特許文献2参照）。このジャイロで用いられている半導体レーザは、ほぼ一定の幅の環状の導波路を備える。そして、その環状の導波路を互いに反対方向に周回する2つのレーザ光を外部に取り出して、その干渉縞を検出する。しかしながら、細い導波路を用いて閉じこめられたレーザ光は、導波路の外部に出射する際に大きく広がってしまうため、実際に干渉縞を精度よく検出することは困難である。そのため、半導体レーザを用いるジャイロでは、半導体レーザの2つの電極間の電圧変化から、2つのレーザ光の周波数差に対応するビート周波数を検出するジャイロ（たとえば特許文献3参照）や、共振器の端面からしみだしたエバネッセント光を用いてビート周波数を検出するジャイロ（たとえば特許文献4参照）が一般的である。

【特許文献1】特開平11-351881号公報

【特許文献2】特開2000-230831号公報

【特許文献3】特開平4-174317号公報

【特許文献4】特開2000-121367号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0 0 0 6】

しかしながら、ビート周波数を検出するジャイロでは、回転方向の検出に特別な装置が必要となる。

【0 0 0 7】

このような状況に鑑み、本発明は、新規な構造の半導体レーザを用いることによって、半導体レーザを用いた従来のジャイロよりも精度よく簡単に回転を検出できる半導体レーザジャイロを提供することを目的の 1 つとする。

【課題を解決するための手段】

【0 0 0 8】

本発明者らは、特別な構造の半導体レーザによって特別なレーザ光を励起できることを見出した。この半導体レーザでは、菱形の経路を互いに逆方向に進む 2 つのレーザ光が励起される。この 2 つのレーザ光は、それぞれよくコリメートされた状態で半導体レーザから外部に出射され、明瞭な干渉縞を形成する。本発明は、この新たな知見に基づくものである。

【0 0 0 9】

本発明の半導体レーザジャイロ（または半導体レーザジャイロ素子）は、第 1 および第 2 のレーザ光を出射する半導体レーザと光検出器とを備える半導体レーザジャイロであって、前記光検出器は、前記第 1 および第 2 のレーザ光によって干渉縞が形成される位置に配置されており、前記半導体レーザは、活性層と前記活性層にキャリアを注入するための第 1 および第 2 の電極とを備え、前記第 1 のレーザ光は、前記活性層内において多角形の経路上を周回するレーザ光（L 1）の一部が出射されたレーザ光であり、前記第 2 のレーザ光は、前記経路上を前記レーザ光（L 1）とは逆の方向に周回するレーザ光（L 2）の一部が出射されたレーザ光である。

【発明の効果】

【0 0 1 0】

本発明によれば、高精度で小型の半導体レーザジャイロを実現できる。本発明のジャイロでは、特別な構造の半導体レーザを用いており、この半導体レーザからは、環状の光路を互いに逆方向に進行する 2 つのレーザ光が、よくコリメートされた状態で出射される。また、この半導体レーザでは、出射端面におけるレーザ光の劣化が小さい。そのため、2 つのレーザ光によって明瞭な干渉縞が形成され、精度よく回転速度（角速度）を検出できる。また、本発明のジャイロによれば、2 つ以上の受光素子で干渉縞の移動を観測することによって、回転速度および回転方向を簡単に算出できる。これらの検出には、希ガスレーザを用いた従来の光ジャイロで用いられている回路と類似の回路を適用できるため、本発明のジャイロは様々な機器への応用が容易である。

【発明を実施するための最良の形態】

【0 0 1 1】

以下、本発明の実施の形態について説明する。なお、以下で説明する半導体レーザジャイロ（半導体レーザジャイロ素子）は本発明の一例であり、本発明は以下の説明に限定されない。また、以下の説明では、同様の部分に同一の符号を付して重複する説明を省略する場合がある。

【0 0 1 2】

本発明の半導体レーザジャイロは、第 1 および第 2 のレーザ光を出射する半導体レーザと光検出器とを備える。光検出器は、第 1 および第 2 のレーザ光によって干渉縞が形成される位置に配置されている。半導体レーザは、活性層と活性層にキャリアを注入するための第 1 および第 2 の電極とを備える。第 1 のレーザ光は、活性層内において多角形の経路上を周回するレーザ光（L 1）の一部が出射されたレーザ光であり、第 2 のレーザ光は、上記経路上をレーザ光（L 1）とは逆の方向に周回するレーザ光（L 2）の一部が出射されたレーザ光である。

【0 0 1 3】

活性層の平面形状は、上記多角形の経路の角部が外縁部に位置するように上記多角形を内包する形状である。活性層に電流が注入されると、光が発生するが、この光は、活性層

の端面で反射されるとともに誘導放出を生じる。そして、活性層の平面形状に応じて、特定の経路を安定に周回するレーザ光（L1およびL2）が励起される。すなわち、活性層は共振器（キャビティ）として機能する。共振器として機能する活性層の端面は、発生した光が所定の形状の経路を周回するように形成される。たとえば、菱形の経路を周回するレーザ光を励起する場合、活性層には、経路（仮想の菱形）の4つの角部のそれぞれに対応する位置に端面（側面）が形成される。活性層およびそれを挟むように配置されるクラッド層は、通常、均一な層であり、上記経路に対応するような一定の幅の導波路は形成されていない。多角形の経路の形状は、活性層の形状によって変化させることができる。多角形の経路の好ましい形状は菱形であるが、他の四角形や三角形であってもよい。

【0014】

（半導体レーザ）

まず、本発明のジャイロに用いられる半導体レーザについて説明する。

【0015】

半導体レーザの活性層は、その平面形状が環状でないことが好ましい。環状に形成された細い導波路内に閉じこめられたレーザ光は、出射される際に広がるため、明瞭な干渉縞が形成されない。そのため、活性層の平面形状は実質的に環状でないことが好ましい。この場合、活性層内にキャリアを注入し、2次元方向に広がる活性層を共振器とする特定のモードのレーザ光、具体的には活性層内を周回するレーザ光を得ることができる。このような活性層から出射されるレーザ光は、よくコリメートされており、そのレーザ光強度の半値幅を 10° 以下（たとえば 5° 以下）とすることが可能である。なお、活性層の中央付近に貫通孔が形成されている場合でも、実質的に環状でない活性層、すなわちほぼ一定の幅の導波路が環状に形成されていない活性層であればよい。なお、この明細書において、「平面形状」とは、図3に示される形状、すなわち、半導体層の積層方向と垂直な方向の形状を意味する。

【0016】

上記多角形の経路は菱形の経路であり、活性層は、上記菱形の経路の第1から第4の角部に対応する位置に形成された第1から第4の端面を有することが好ましい。すなわち、第1から第4の端面上には、それぞれ、菱形の経路の第1から第4の角部が位置する。この場合、活性層にキャリアを注入することによって、菱形上を周回するレーザ光が励起される。すなわち、レーザ光（L1）は、上記菱形の経路上を周回するレーザ光であり、レーザ光（L2）は、上記菱形の経路上をレーザ光（L1）とは逆の方向に周回するレーザ光である。

【0017】

第1および第2の電極から選ばれる少なくとも1つの電極と半導体レーザを構成する半導体層とが、上記菱形の経路（多角形の経路）に沿って接触することが好ましい。電流は、接触している領域を介して注入される。この構成によれば、活性層のうち上記菱形の経路の部分にキャリアを注入でき、菱形の経路上を周回する2つのレーザ光（L1およびL2）が容易に励起される。典型的な一例では、上記少なくとも1つの電極が、菱形の経路（多角形の経路）に実質的に対応するように半導体層と接触する。これらの場合、上記少なくとも1つの電極と半導体層とが環状に接触していてもよい。なお、この明細書において、「菱形の経路に実質的に対応するように」とは、菱形の経路に完全に対応する場合に加えて、菱形の経路の50%以上（好ましくは、70%以上でより好ましくは90%以上）に対応する場合を含む。また、「環状に接触」とは、接触している領域が実質的に環を形成していればよく、完全に連続した環でなくともよいことを意味している。また、菱形の経路に対応する上記領域の面積は、活性層の平面形状の面積に対して通常50%以下であり、たとえば30%以下である。

【0018】

第1および第2の電極から選ばれる少なくとも1つの電極は、利得が発生する電流を注入する第1の部分と、第1の部分よりも少ない電流を注入する第2の部分とを含んでもよい。第1の部分ではレーザ発振に必要な電流が注入される。第2の部分には、利得が発生

しないように弱い電流を注入することによって、菱形の光路以外の方向に進行するレーザー光を減衰させることができる。

【0 0 1 9】

上記菱形の経路の対向する第 1 および第 2 の角部の内角は、第 3 および第 4 の角部の内角よりも角度が小さく、第 1 および第 2 のレーザー光はともに第 1 の角部に対応する位置に形成された第 1 の端面から出射されることが好ましい。より具体的には、第 1 および第 2 のレーザー光は、キャビティーとして機能する活性層の長手方向の一方端から出射されることが好ましい。第 1 の角部と第 2 の角部とを結ぶ対角線と、第 1 および第 2 のレーザーとは非平行である。

【0 0 2 0】

活性層は、レーザー光 (L 1) およびレーザー光 (L 2) が第 3 および第 4 の端面において全反射する条件を満たすことが好ましい。第 1 から第 4 の端面はミラー面として機能するが、第 3 および第 4 の端面でレーザー光を全反射させることによって、レーザー発振の閾値を下げるることができる。第 3 および第 4 の端面においてレーザー光を全反射させるためには、第 3 および第 4 の端面と、それに入射するレーザー光 (L 1 および L 2) とがなす角度を、一定以下の角度とすればよい。全反射に必要な角度は、レーザー光の波長と活性層の屈折率とから簡単に導かれる。活性層の端面とレーザー光とがなす角度は、菱形の経路の形状を変化させることによって、すなわち、活性層の平面形状を変化させることによって調節できる。レーザー光の波長や活性層の材質によって好ましい形状は異なるが、第 1 の角部と第 2 の角部との距離 (菱形の長い方の対角線の長さ) と、第 3 の角部と第 4 の角部とを結ぶ距離 (菱形の短い方の対角線の長さ) との比は、たとえば、6 0 0 : 1 9 0 ~ 6 0 0 : 3 0 の範囲とされる。第 1 の端面はミラー面ではあるが、活性層内を周回するレーザー光の一部が外部に出射されるように、通常、ミラーコート処理などは行わない。なお、第 1 の端面には、レーザー光が外部に出射しやすいような処理をしてもよい。また、第 2 の角部における活性層の端面は、ミラーコート処理がされていることが好ましい。

【0 0 2 1】

活性層の第 1 の端面は、曲面であることが好ましい。特に、第 1 および第 2 の端面は、それぞれ、外側に凸の曲面であることが好ましい。この構成によれば、菱形の経路を周回するレーザー光を安定に発生させることができるとともに、第 1 および第 2 のレーザー光を第 1 の端面から安定に出射できる。外側に凸の 2 つの曲面は、それぞれ、菱形の経路の第 1 および第 2 の角部を結ぶ対角線上に中心を有する円柱の一部であることが好ましい。なお、第 1 および第 2 の端面から選ばれる少なくとも 1 つを平面または内側に凸の曲面とすることも可能である。

【0 0 2 2】

上述した円柱の半径、すなわち、上記第 1 の端面の曲率半径 R 1 および第 2 の端面の曲率半径 R 2 は共に、第 1 の角部と第 2 の角部との間の距離 L 以上であることが好ましい。この構成によれば、菱形の光路を周回するレーザー光 (L 1 および L 2) を安定に励起できる。R 1 および R 2 の上限は特に限定はないが、たとえば距離 L の 2 倍以下である。

【0 0 2 3】

活性層は、菱形の経路を含む第 1 の領域と、第 1 の領域に隣接する第 2 の領域とを含むことが好ましい。この場合、第 1 の領域の平面形状は、略長方形であることが好ましく、より詳細には、長方形の短辺を外側に凸の曲面とした形状であることが好ましい。この構成では、第 1 の領域を共振器として菱形の光路を進むレーザー光が励起される。また、この構成によれば、菱形の経路以外の方向に進むレーザー光を第 2 の領域によって減衰させることができる。

【0 0 2 4】

上記第 1 の領域と第 2 の領域とによって構成される活性層の平面形状は略 H 字状 (より詳細には、H を横に伸ばした形状) であることが好ましい (図 3 参照)。この場合、第 1 の領域には、4 つの第 2 の領域が隣接する。この場合、第 1 の角部と第 2 の角部とを結ぶ対角線に平行な方向における第 2 の領域の長さ L s (μ m) と、第 1 の角部と第 2 の角部

との距離 L (μm) とが、 $L/4 < L_s$ を満たすことが好ましい。また、第 3 の角部と第 4 の角部とを結ぶ対角線に平行な方向における第 2 の領域の長さ W_s (図 3 参照) は、たとえば、第 3 の角部と第 4 の角部とを結ぶ距離 W の 1 ~ 3 倍の範囲である。

【0025】

本発明の半導体レーザを構成する半導体および積層構造に特に限定はなく、利用するレーザ光の波長などに応じて選択される。レーザ光 (L_1 および L_2) の波長に特に限定はないが、波長が短い方が高い精度で回転の角速度を検出できる。好ましい波長は、1550 nm 以下であり、特に好ましくは 900 nm 以下である。半導体層の材料の一例としては、たとえば、III-V 族化合物半導体が挙げられる。

【0026】

以下、本発明で用いられる半導体レーザの好ましい一例について説明する。半導体レーザの一例の斜視図を図 1 に示し、図 1 の線 I-I における断面図を図 2 に示す。図 2 において、絶縁層 12 以外のハッチングは省略する。なお、本発明の説明に用いる図面は模式的なものであり、理解が容易なように各部の縮尺を変更している。

【0027】

図 1 の半導体レーザ 10 は、基板 11 と、基板 11 上に形成された半導体層 20 と、半導体層 20 上に形成された絶縁層 12 および第 1 の電極 13 と、基板 11 の裏面側の全面に形成された第 2 の電極 14 とを備える。

【0028】

図 2 を参照して、半導体層 20 は、基板 11 側から順に積層された、バッファ層 21、バッファ層 22、グレーデッド層 23、クラッド層 24、グレーデッド層 25、活性層 26、グレーデッド層 27、クラッド層 28 およびキャップ層 29 を含む。キャップ層 29 の上には、パターンニングされた絶縁層 12 が形成されている。絶縁層 12 上には、第 1 の電極 13 が形成されている。絶縁層 12 には貫通孔が形成されているため、第 1 の電極 13 とキャップ層 29 とは、貫通孔が形成されている領域 31 で接触する。

【0029】

半導体レーザ 10 の活性層 26 を上方から見たときの平面形状を図 3 および図 4 に示す。図 4 には、第 1 の電極 13 と半導体層 20 (キャップ層 29) とが接触している領域 31 の部分を斜線で示す。なお、半導体層 20 は、活性層 26 と同じ平面形状を有する。

【0030】

図 3 を参照して、活性層 26 は、菱形の経路 32 を含む面状に形成された薄膜である。経路 32 の第 1 から第 4 の角部 32a ~ 32d のうち、第 1 および第 2 の角部 32a および 32b は、第 3 および第 4 の角部 32c および 32d よりも角度が小さい。活性層 26 は、角部 32a ~ 32d を含むように配置された第 1 から第 4 の端面 (ミラー面) 26a ~ 26d を有する。第 1 および第 2 の端面 26a および 26b は、外側に向かって凸の曲面である。第 3 および第 4 の端面 26c および 26d は、フラットな平面である。

【0031】

活性層 26 は、第 1 の領域 26f と、第 1 の領域に隣接する 4 つの第 2 の領域 26s とを備える。第 1 の領域 26f の平面形状は、長方形の短辺を外側に凸の曲面とした形状である。経路 32 は、第 1 の領域 26f 内に形成される。第 1 の領域 26f と第 2 の領域 26s とによって構成される活性層 26 は、略 H 字状の形状 (より詳しくは H の字を横に引き延ばした形状) をしている。

【0032】

図 4 を参照して、第 1 の電極 13 と絶縁層 12 とが接触している領域 31 は、経路 32 に対応するように、略菱形に形成される。領域 31 が経路 32 に完全に対応していないのは、絶縁層 12 に貫通孔を形成する際に、製造工程上の制限があるためである。経路 32 に完全に対応するように領域 31 を公知の方法で菱形に形成することは可能であるが、製造工程が複雑になる。

【0033】

第 1 の電極 13 と第 2 の電極 14 との間に電圧を印加して活性層 26 にキャリアを注入

すると、活性層 26 で光が発せられる。この光は、グレーデッド層 25 および 27 によって閉じこめられるため、活性層 26 内を移動する。そのような光の中で、経路 32 上を進行する光は、端面 26 a ~ 26 d によって反射されながら誘導放出を生じる。このため、経路 32 を光路として周回するレーザ光 L1 が発生する。同様に、経路 32 を光路としてレーザ光 L1 とは反対の方向に周回するレーザ光 L2 が発生する。レーザ光 L1 および L2 のうちの一部が、第 1 の端面 26 a の第 1 の角部 32 a から出射され、第 1 および第 2 のレーザ光 35 および 36 となる（図 4 参照）。

【0034】

レーザ光 L1 および L2 の損失を少なくするため、端面 26 b には、誘電体多層膜によるミラーコートがされている。第 1 の角部 32 a と第 2 の角部 32 b との間の距離 L（図 3 参照）は $600\mu\text{m}$ であり、第 3 の角部 32 c と第 4 の角部 32 d との間の距離 W は $60\mu\text{m}$ である。半導体レーザ 10 では、端面 26 c および 26 d において、レーザ光（L1 および L2）が全反射する。

【0035】

4 つの第 2 の領域 26 s は、第 1 の領域 26 f で発生したレーザ光が端面 26 c および 26 d で多重反射されることによって発生するモードを抑制するために形成される。半導体レーザ 10 では、第 1 の角部 32 a と第 2 の角部 32 b とを結ぶ対角線 32 a b に平行な方向における第 2 の領域 26 s の長さ L_s （図 3 参照）が $160\mu\text{m}$ である。一方、 $L/4$ は $150\mu\text{m}$ であり、 $L/4 < L_s$ が満たされるため、上記モードが特に抑制される。また、第 3 の角部 32 c と第 4 の角部 32 d とを結ぶ対角線 32 c d の方向における第 2 の領域 26 s の長さ W_s は $70\mu\text{m}$ である。

【0036】

端面 26 a および 26 b の形状は、それぞれ、円柱の曲面の一部の形状である。具体的には、対角線 32 a b 上であって活性層 26 の表面と垂直に中心軸が配置された円柱の曲面の一部と同じ形状である。その円柱の半径、すなわち端面 26 a の曲率半径 R_1 （図 3 参照）は $600\mu\text{m}$ であり、端面 26 b の曲率半径 R_2 （図示せず）も同じく $600\mu\text{m}$ である。半導体レーザ 10 は、対角線 32 a b および対角線 32 c d に対して線対称の形状であり、端面 26 b は、第 3 の角部 32 c と第 4 の角部 32 d とを結ぶ対角線 32 c d に対して端面 26 a と線対称の形状である。ただし、本発明の半導体レーザは必ずしも線対称の形状ではなくともよく、たとえば、端面 26 b は、端面 26 a とは曲率が違う曲面であってもよく、平面であってもよく、内側に凸の曲面であってもよい。

【0037】

基板 11、半導体層 20、絶縁層 12、第 1 の電極 13 および第 2 の電極 14 の材料および膜厚について、表 1 に示す。表 1 において、一部の半導体層については、バンドギャップ E_g と、多数キャリアおよびその濃度についても示す。

【0038】

【表 1】

層	組成	厚さ [μm]	E_g [eV]	多数キャリアと その濃度 [cm^{-3}]	
第1の電極13	Au Pt Ti	0.6 0.05 0.07	—	—	
絶縁層12	Si_3N_4 または SiO_2	0.4	—	—	
キャップ層29	Beドーパ形 GaAs	0.2	1.41	正孔 1×10^{19}	
クラッド層28	Beドーパ形 $\text{Al}_{0.5}\text{Ga}_{0.5}\text{As}$	1.5	2.0	正孔 10^{18} 台	
グレーデッド層 27	Beドーパ形 $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$	0.202			
活性層26	ノドーパ GaAs	0.01			
グレーデッド層 25	Siドーパ形 $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$	0.202			
クラッド層24	Siドーパ形 $\text{Al}_{0.5}\text{Ga}_{0.5}\text{As}$	1.5	2.0	電子 10^{18} 台	
グレーデッド層 23	Siドーパ形 $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$	0.2		電子 10^{18} 台	
バッファ層22	Siドーパ形 $\text{Al}_{0.2}\text{Ga}_{0.8}\text{As}$	1.0	1.7	電子 1×10^{18}	
バッファ層21	Siドーパ形 GaAs	0.2	1.41	電子 3×10^{18}	
基板11	単結晶 GaAs				
第2の電極14	Ni Ge Au	0.02 0.1 0.5	—	—	

【0039】

なお、第1の電極13および第2の電極14を構成する各層は、熱処理によって合金化されていてもよい。また、表1に示す構成は一例であり、半導体レーザに求められる特性に応じて適宜変更される。

【0040】

バッファ層21および22、ならびにグレーデッド層23は、品質が高いIII-V族化合物半導体結晶を得るために形成される。

【0041】

グレーデッド層23のアルミニウムの組成比Xは、バッファ層22側からクラッド層24側に向かって徐々に増加する。具体的には、組成比Xは、バッファ層22との界面では0.2であり、クラッド層24との界面では0.5である。

【0042】

グレーデッド層25において、ドーパントであるSiの濃度はクラッド層24側から活性層26側に向かって徐々に減少する。具体的には、クラッド層24との界面では約 $1 \times$

$1.0 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ であり、活性層 26 との界面では約 $1 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ である。また、グレーデッド層 25 のアルミニウムの組成比 X も、クラッド層 24 側から活性層 26 側に向かって放物線状に減少する。具体的には、組成比 X は、クラッド層 24 との界面では 0.5 であり、活性層 26 との界面では 0.2 である。

【0043】

グレーデッド層 27 において、ドーパントである Be の濃度は活性層 26 側からクラッド層 28 側に向かって徐々に増加する。具体的には、活性層 26 との界面では約 $1 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ であり、クラッド層 28 との界面では約 $1 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ である。また、グレーデッド層 27 の Al の組成比 X も、活性層 26 側からクラッド層 28 側に向かって放物線状に増加する。具体的には、組成比 X は、活性層 26 との界面では 0.2 であり、クラッド層 28 との界面では 0.5 である。

【0044】

半導体層 20 のバンドギャッププロファイルを図 5 に模式的に示す。グレーデッド層 25 のバンドギャップは、クラッド層 24 から活性層 26 側に向かって 2.0 eV から 1.7 eV まで放物線状に減少する。グレーデッド層 27 のバンドギャップは、活性層 26 からクラッド層 28 側に向かって 1.7 eV から 2.0 eV まで放物線状に増加する。

【0045】

半導体レーザ 10 は、いわゆる単一量子井戸形のレーザであり、2つの電極から注入されたキャリアは活性層 26 に閉じこめられて低い閾値電流でレーザ発振が開始される。なお、活性層 26 は、多重量子井戸形などの他の形態であってもよい。

【0046】

クラッド層 24 ～クラッド層 28 までの屈折率の変化を図 6 に模式的に示す。クラッド層 24、グレーデッド層 25、グレーデッド層 27 およびクラッド層 28 は、活性層 26 内に光を閉じこめるために活性層 26 よりも屈折率が低い材料からなる。活性層 26 の屈折率が最も高いため、活性層 26 で発生した光は、活性層 26 に閉じこめられる。

【0047】

なお、半導体レーザ 10 の第 1 の電極 13 は、利得が発生する電流を注入する第 1 の部分 13a と、第 1 の部分 13a よりも少ない電流を注入する第 2 の部分 13b とを含んでもよい。そのような電極と半導体層 20（キャップ層 29）とが接触する領域の形状と、活性層 26 の平面形状と、経路 32 との関係を図 7 に示す。なお、図 7 では、第 1 の部分 13a がキャップ層 29 と接触する領域 31a と、第 2 の部分 13b がキャップ層 29 と接触する領域 31b とを、ハッチングを付して示している。領域 31a は経路 32 の 1 つの辺に対応する位置に形成され、領域 31b は他の 3 つの辺に対応する位置に形成される。このような電極は、絶縁層 12 の形状を変更することによって容易に形成できる。

【0048】

半導体レーザ 10 では、注入される電流が閾値電流を超えるとシングルモードの発振を開始する。そして、注入される電流が閾値電流からさらに増加するに従って、発振のモードが、シングルモード、ツインモード、ロッキングモードという順で変化する。シングルモードでは、図 4 に示すように、第 1 および第 2 のレーザ光 35 および 36 が出射される。ツインモードでは、2つのレーザ光が周期的に交互に出射される。ロッキングモードでは、2つのレーザ光のうちの 1 つのレーザ光のみが出射される。したがって、本発明では、通常、半導体レーザ 10 をシングルモードで動作させる。具体的には、たとえば、第 1 の電極 13 と第 4 の電極 14 との間に、200 mA の電流を流すことによって、レーザを発振させればよい。なお、本発明のジャイロでは、注入する電流によって発振のモードを変更できることを利用して、特別な機能を付与してもよい。

【0049】

半導体レーザ 10 をシングルモードで発振させたときのレーザ光の光強度の角度依存性を、第 1 の端面 26a から約 300 mm の距離で測定した結果を図 8 に示す。図 8 に示すように、 0° の方向（対角線 32ab の方向）からの角度がほぼ等しい方向に、強度がほぼ等しい 2 つのレーザ光が出射された。2つのレーザ光の波長は 862 nm であった。ま

た、2つのレーザ光の強度の半値幅は、 4.2° であった。また、2つのレーザ光が対角線 3 2 a b の方向となす角度は、それぞれ約 19.2° であった。このように、半導体レーザ 1 0 は、対角線 3 2 a b に対して対称な方向に、強度がほぼ等しく、よくコリメートされた2つのレーザ光を出射した。対角線 3 2 a b と、第1のレーザ光（または第2のレーザ光）とがなす角度 θ は、通常、以下の式（2）で表されると考えられる。

【0 0 5 0】

【数 2】

$$\theta = \pm \sin^{-1} \left(\frac{W \cdot n_{\text{eff}}}{\sqrt{L^2 + W^2}} \right) \dots (2)$$

【0 0 5 1】

L および W はそれぞれ図 3 に示される長さであり、 $L = 600 \mu\text{m}$ 、 $W = 60 \mu\text{m}$ である。また、 n_{eff} は光の閉じ込めを行うクラッド層 2 4 ～クラッド層 2 8 の実効屈折率であり、半導体レーザ 1 0 では、約 3.3 である。これらの値を用いて θ を計算すると、 $\theta = 19.2^\circ$ となり、実際の結果とよく一致した。上記式に基づけば、第1および第2のレーザ光 3 5 および 3 6 の出射角度は、活性層の屈折率や、L と W との比を変化させることによって制御できる。

【0 0 5 2】

半導体レーザ 1 0 から出射された2つのレーザ光は、端面 2 6 a の近傍で重なるため、端面 2 6 a の近傍で規則正しい干渉縞（余弦波）を生じる。端面 2 6 a の近傍で測定した干渉縞を図 9 に示す。

【0 0 5 3】

（半導体レーザジャイロ）

本発明のジャイロは、第1および第2のレーザで干渉縞が形成された位置に配置された光検出器を備える。光検出器は、干渉縞の移動を検出できるものであれば特に限定がなく、通常は、フォトダイオードやフォトトランジスタといった半導体受光素子が用いられる。光検出器は、干渉縞の光量の強弱に応じた信号を出力する。干渉縞が移動すると、光検出器に入力される光量が周期的に変化するため、干渉縞の移動速度を算出できる。

【0 0 5 4】

光検出器は、複数の受光素子を備える2チャンネルの光検出器であってもよい。2つ以上の受光素子を干渉縞の移動方向に配置することによって、干渉縞の移動速度に加えて干渉縞の移動方向を検出することができる。干渉縞の移動速度と移動方向とを検出することによって、半導体レーザジャイロの回転方向と回転速度とを算出できる。

【0 0 5 5】

本発明のジャイロでは、上記半導体レーザと光検出器（受光素子）とが、モノリシックに形成されていてもよい。この場合、半導体レーザと光検出器（たとえばフォトダイオード）とが同じ積層構造を有してもよい。この構成では、半導体レーザと光検出器とを、半導体素子を製造する一連のプロセスで同時に形成できる。そのため、製造が容易であると共に、半導体レーザと光検出器とを正確な配置に形成できる。

【0 0 5 6】

本発明のジャイロは、レンズをさらに備えてもよい。この場合、光検出器は、レンズを透過した第1および第2のレーザ光によって干渉縞が形成される位置に配置される。半導体レーザの半導体層とレンズとは、同じ積層構造を有してもよい。この場合のレンズは、たとえば、平面形状が半円状のレンズであり、レンズとして機能する部分は、半導体レーザの活性層と同じ半導体からなる。そのため、レンズに入射した光は、半導体からなるレンズで吸収されて減衰する。そのような減衰を抑制するために、レンズを構成する積層された半導体層に電流を流してもよい。電流を流すには、たとえば、電極を含めて半導体レ

ーザとレンズとを全く同じ積層構造とすればよい。流す電流は、レーザ発振を生じる電流よりは少ないことが望ましい。電流を流すことによってレンズによる光の減衰を抑制できる。また、レンズによる光の減衰を抑制するために、レーザ光の吸収が少ない材料、たとえば、酸化シリコンなどでレンズを形成してもよい。その場合でも、製造工程は多くなるが、レンズと半導体レーザとを公知の方法でモノリシックに形成できる。

【0057】

本発明のジャイロは、プリズムをさらに備えてもよい。この場合、光検出器は、プリズムを透過した第1および第2のレーザ光によって干渉縞が形成される位置に配置される。所定の形状のプリズムを用いることによって、形成される干渉縞の周期長を長くすることができ、干渉縞の移動をより正確に測定できる。

【0058】

半導体レーザジャイロがプリズムを備える場合、半導体レーザとプリズムとがモノリシックに形成されてもよい。また、半導体レーザとプリズムと光検出器とがモノリシックに形成されてもよい。これらの構成によれば、各素子を所定の位置および形状に精度よく形成できる。さらにこの場合、半導体レーザの半導体層とプリズムとが同じ積層構造を有してもよい。また、半導体レーザの半導体層と、光検出器（たとえばフォトダイオード）の半導体層と、プリズムとが同じ積層構造を有してもよい。この構成によれば、半導体レーザを製造する一連のプロセスで、光検出器および／またはプリズムを形成できる。

【0059】

なお、プリズムの積層構造を半導体レーザの半導体層と同じ積層構造とした場合、半導体レーザから出射されたレーザ光は、半導体からなるプリズムに入射して減衰する。そのような減衰を抑制するために、プリズムを構成する積層された半導体層に電流を流してもよい。電流を流すには、たとえば、電極を含めて半導体レーザとプリズムとを全く同じ積層構造とすればよい。流す電流は、レーザ発振を生じる電流よりは少ないことが望ましい。電流を流すことによってプリズムによる光の減衰を抑制できる。また、プリズムによる光の減衰を抑制するために、レーザ光の吸収が少ない材料、たとえば、酸化シリコンなどでプリズムを形成してもよい。その場合でも、製造工程は多くなるが、プリズムと半導体レーザとを公知の方法でモノリシックに形成できる。

【0060】

図4を参照しながら、本発明の半導体レーザジャイロの原理を簡単に説明する。半導体レーザ10が回転すると、レーザ光L1とレーザ光L2とでは、経路32の光路を一周するのに要する時間が増加する。光の速度は一定であるため、半導体レーザ10が回転すると、レーザ光L1とレーザ光L2との間で周波数差が生じ、その周波数差に応じた速度で干渉縞が移動する。干渉縞の移動方向は、半導体レーザ10の回転方向に応じて変化する。このため、干渉縞の移動速度を測定することによって、半導体レーザ10の回転速度（角速度）を算出でき、干渉縞の移動方向を検出することによって半導体レーザの回転方向を検出できる。より具体的には、活性層26の表面と平行な面内における回転方向と回転速度とを算出できる。上述したように、このような光ジャイロの原理は公知の原理であり、希ガスレーザを用いた光ジャイロなどで利用されている。したがって、本発明の半導体レーザジャイロは、公知の駆動回路で駆動でき、ジャイロによって得られた情報は公知の方法で処理できる。なお、本発明の半導体レーザジャイロを3つ組み合わせることによって、全方向における回転方向と回転速度とを算出することが可能である。

【0061】

以下、本発明の半導体レーザジャイロについて、例を挙げて説明する。なお、以下の実施形態では、第1の電極13が図7に示した電極である場合について示しているが、第1の電極13は図1および図4に示した電極であってもよい。

【0062】

（実施形態1）

実施形態1では、半導体レーザと光検出器とがモノリシックに形成されている半導体レーザジャイロの一例について説明する。実施形態1のジャイロ101の斜視図を図10（

a) に示す。また、半導体レーザジャイロ 101 の半導体レーザ 10 および光検出器 113 (受光素子 113a および 113b) がモノリシックに形成された基板 11 の斜視図を図 10 (b) に示す。なお、図 10 (a) では、カバー 111 の一部を切断して内部を解放した状態を示している (以下の図においても同様である)。

【0063】

図 10 (a) を参照して、ジャイロ 101 の主要部は、カバー 111 とステム 112 とによってパッケージ (いわゆる CAN パッケージ) されている。ジャイロ 101 は、ステム 112 と、ステム 112 上に配置された基板 11 とを備える。半導体レーザ 10 と受光素子 113a および 113b とは、基板 11 を共有してモノリシックに形成されている。ステム 112 は、5 本の電極 114 で支持されている。5 本の電極のうちの 4 つは、それぞれ、半導体レーザ 10 の第 1 の電極 13 の第 1 の部分 13a、第 2 の部分 13b、受光素子 113a、および受光素子 113b に接続されている。5 本の電極のうちの残りの 1 つは、上記 4 つの電極と対になる接地電極である。なお、電極 114 の接続方法は一例であり、本発明はこれに限定されない。円形のステム 112 の直径に限定はないが、規格で決められたサイズ、たとえば直径 5.6 mm とすることができる。

【0064】

受光素子 113a および 113b はフォトダイオードであり、半導体レーザ 10 と同じ積層構造を有する。受光素子 113a および 113b は、半導体レーザ 10 を形成する製造工程で半導体レーザ 10 とともに形成される。

【0065】

受光素子 113a および 113b は、図 9 に示したような干渉縞の移動方向および移動速度を検出するために、レーザ光が出射される第 1 の端面 26a に近接して配置される。なお、干渉縞の移動速度を精度よく検出するために、光検出器の受光領域のサイズは、干渉縞の周期長や、光検出器の受光感度を考慮して決定される。通常、受光領域のサイズは、干渉縞の周期長の 5 分の 1 程度以下とすることが好ましい。

【0066】

実施形態 1 の半導体レーザジャイロ 101 は、プリズムやレンズなどの光学素子を必要としないという利点がある。一方、半導体レーザジャイロ 101 を得るには、微細な受光素子 113a および 113b を形成する必要がある。

【0067】

(実施形態 2)

実施形態 2 では、レンズを備える半導体レーザジャイロの一例について説明する。実施形態 2 のジャイロ 102 の斜視図を図 11 (a) に示す。また、ジャイロ 102 で用いられる半導体レーザ 10 の斜視図を図 11 (b) に示す。

【0068】

ジャイロ 102 は、半導体レーザ 10 と、球面レンズ 115 と、光検出器 116 とを備える。光検出器 116 は、2 つの受光素子を備える 2 チャンネルの光検出器である。ジャイロ 102 は 5 本の電極 114 を備えている。電極 114 はジャイロ 101 と同様に接続される。

【0069】

球面レンズ 115 は、その焦点が、レーザ光の出射部 (端面 26a) の近傍に位置するように配置される。また、光検出器 116 は、端面 26a から一定の距離 (たとえば数センチメートル) 離れた位置に配置される。したがって、ジャイロ 102 の一例のサイズは、3 cm × 2 cm × 1 cm 程度である。

【0070】

端面 26a から出射される 2 つのレーザ光は、球面レンズ 115 で略平行な光となり、重なり合って干渉縞を生じる。球面レンズ 115 を用いることによって干渉縞の周期長を長くできるため、ジャイロ 102 では、干渉縞の移動を正確に測定できる。

【0071】

なお、球面レンズ 115 は、球状に限らず、薄膜などの他の形状であってもよい。たと

えば、平面形状が半円状の薄膜状レンズを用いてもよい。この場合、レンズを基板 11 上にモノリシックに形成してもよい。レンズの材料としては、 SiO_2 などの透明材料を用いることができるが、半導体を用いてもよい。たとえば、半導体レーザの半導体層とレンズとは同じ積層構造を有してもよい。

【0072】

(実施形態 3)

実施形態 3 では、半導体レーザとプリズムとがモノリシックに形成されている半導体レーザジャイロの一例について説明する。実施形態 3 のジャイロ 103 の斜視図を図 12 (a) に示す。また、半導体レーザ 10 およびプリズム 117 が形成された基板 11 の斜視図を図 12 (b) に示す。

【0073】

ジャイロ 103 は、ステム 112 と、ステム 112 上に配置された半導体レーザ 10 および 2 チャンネルの光検出器 116 と、基板 11 上に形成されたプリズム 117 とを備える。プリズム 117 は半導体レーザ 10 の半導体層 20 と同じ積層構造を有し、半導体レーザ 10 とモノリシックに形成されている。そのため、プリズム 117 は、半導体層 20 を形成する際に同時に形成できる。

【0074】

ジャイロ 103 における 2 つのレーザ光の光路を図 13 に模式的に示す。半導体レーザ 10 から出射された 2 つのレーザ光は、プリズム 117 で重ね合わされて干渉縞を生じる。干渉縞の移動は、光検出器 116 の 2 つの受光素子 116a および 116b によって観測される。干渉縞は、ジャイロ 103 の回転速度に応じた速度で矢印の方向に移動する。干渉縞の移動方向は、ジャイロ 103 の回転方向に対応して変化する。

【0075】

プリズム 117 の形状は、入射する 2 つのレーザ光の角度や間隔、および光検出器 116 との距離などの条件に応じて決定される。干渉縞の周期長を長くするために、プリズム 117 の断面形状である三角形の最も大きい角は 90° (0.5π ラジアン) よりも僅かに大きいことが好ましい。その角の角度を $(0.5\pi + \epsilon)$ ラジアンとすると、 ϵ は、 0.5 ラジアン以下であることが好ましい。

【0076】

(実施形態 4)

実施形態 4 では、半導体レーザとプリズムと光検出器とがモノリシックに形成されている半導体レーザジャイロの一例について説明する。実施形態 4 のジャイロ 104 の斜視図を図 14 (a) に示し、主要部の斜視図を図 14 (b) に示す。

【0077】

半導体レーザ 10 と、プリズム 117 と、光検出器 113 (受光素子 113a および 113b) とは、基板 11 上にモノリシックに形成されている。ジャイロ 104 では、図 13 と同様の光路を進む 2 つのレーザ光で干渉縞が形成される。

【0078】

半導体レーザ 10 の半導体層 20 と、受光素子 113a および 113b の半導体層と、プリズム 117 とは、同じ積層構造を有する。これらは、半導体層 20 を形成する過程で同時に形成できるため、製造が容易である。また、これらは半導体プロセスで形成できるため、正確な位置および形状に形成できる。なお、プリズム 117 だけを他の材料、たとえば SiO_2 などで形成することも可能である。

【0079】

(半導体レーザジャイロの製造方法)

本発明のジャイロで用いられる半導体レーザの製造方法に限定はなく、公知の半導体製造技術によって製造できる。また、本発明のジャイロは、半導体レーザと他の部材とを公知の技術で組み立てることによって容易に製造できる。以下に、半導体レーザ 10 を製造する方法の一例を説明する。

【0080】

図15 (a) ~ (h) に、製造工程を模式的に示す。なお、図15 (a) ~ (h) では、絶縁層12の形成状態の理解を容易にするため、絶縁層12の表面にハッチングを付す。

【0081】

まず、図15 (a) に示すように、基板11上に、複数の半導体層からなる半導体層20aと、厚さ0.4 μm の絶縁層12aとを形成する。半導体層20aは、エッチングによって半導体層20 (図2および表1参照) となる層である。半導体層20aを構成する各層は、一般的な方法、たとえば、MBE (Molecular Beam Epitaxy) 法やCVD (Chemical Vapor Deposition) 法で形成できる。絶縁層12aは、たとえば Si_3N_4 や SiO_2 からなる。絶縁層12aは、スパッタリング法やCVD法といった方法で形成できる。

【0082】

次に、図15 (b) に示すように、絶縁層12a上に、パターンニングされたレジスト膜151を形成する。レジスト膜151は、図3に示した活性層26の形状にパターンニングする。

【0083】

次に、図15 (c) に示すように、レジスト膜151をマスクとして、絶縁層12aと半導体層20aと基板11の一部とをエッチングしたのち、レジスト膜151を除去する。エッチングは、RIE (Reactive Ion Etching) 法によって行い、少なくともクラッド層24の深さまでエッチングする。エッチングによって、所定の形状の絶縁層12および半導体層20が形成される。エッチングは、半導体層20の側面の垂直性および平滑性が高くなるような条件で行われる。そのような条件は、半導体製造プロセスで一般的に採用されている。エッチングによって、半導体層20を構成するすべての半導体層の平面形状は、図3に示した活性層26の平面形状と同じになる。また、半導体層20の側面はミラー面として機能する。

【0084】

次に、図15 (d) に示すように、領域31 (図2および図4参照) に対応するように、絶縁層12に略菱形の貫通孔12hを形成する。貫通孔12hは、一般的なフォトリソ・エッチング工程で形成できる。

【0085】

次に、図15 (e) に示すように、基板11の表面全体を覆うようにレジスト膜152を形成する。このとき、基板11の表面と絶縁層12の表面との間の段差を埋めるために、レジスト膜152は、レジスト層152aおよびレジスト層152bの2層からなることが好ましい。レジスト膜152は、レジスト層152aを基板11の表面全体に塗布して段差を埋めたのち、レジスト層152bを塗布することによって形成できる。この方法によれば、表面の平坦性が高いレジスト膜152を形成できる。

【0086】

次に、図15 (f) に示すように、レジスト膜152をパターンニングし、レジスト膜152に貫通孔152hを形成する。貫通孔152hは、第1の電極13を形成する領域に対応する形状に形成される。貫通孔152hを形成したのち、半導体層20 (キャップ層29) と第1の電極13との間で良好なコンタクトが得られるように、貫通孔152h内の半導体層20 (キャップ層29) の表面を0.01 μm ~ 0.02 μm 程度エッチングする。

【0087】

次に、図15 (g) に示すように、第1の電極13を形成する。第1の電極13は、リフトオフ法で形成できる。具体的には、まず、レジスト膜152をマスクとして、第1の電極13を構成する複数の金属層を電子ビーム法で順次成膜する。その後、レジスト膜152をアセトンで除去する。このようにして、所定の形状の第1の電極13を形成できる。第1の電極13は、絶縁層12に形成された貫通孔12hを介して半導体層20 (キャップ層29) に接触する。

【0088】

1枚の基板11（ウェハ）を用いて多数の半導体レーザを形成する場合、基板11のへき開を容易にするため、基板11の厚さが100～150 μ mになるように基板11の裏面を研磨することが好ましい。

【0089】

次に、図15（h）に示すように、基板11の裏面側に複数の金属層を蒸着法で順次形成して第2の電極14を形成する。その後、第1の電極13および第2の電極14を構成する金属層を合金化するために、400～450℃で熱処理する。最後に、必要に応じて、半導体レーザごとに基板11をへき開する。

【0090】

このようにして、半導体レーザ10が形成される。なお、半導体レーザ10と同じ積層構造を有するフォトダイオードをモノリシックに形成する場合には、半導体レーザを形成する部分とフォトダイオードを形成する部分とに対応するように、レジスト膜151および152をパターンニングすればよい。同様に、半導体レーザの半導体層と同様の積層構造を有するプリズムを形成する場合には、半導体レーザを形成する部分とプリズムを形成する部分とに対応するようにレジスト膜151をパターンニングすればよい。

【0091】

なお、基板11には、光検出器およびプリズム以外の、他の光学素子や電子部品を形成してもよい。たとえば、半導体レーザを駆動するための駆動回路や、光検出器から出力された信号を処理するための回路を形成してもよい。また、本発明の半導体レーザジャイロに、従来のジャイロに用いられている公知の技術をさらに適用してもよい。

【0092】

以上、本発明の実施形態について例を挙げて説明したが、本発明は上記実施形態に限定されず、本発明の技術的思想に基づいて他の実施形態に適用できる。

【産業上の利用可能性】

【0093】

本発明の半導体レーザジャイロは、物体の回転の検出が必要な様々な機器に適用できる。代表的な例としては、姿勢制御装置やナビゲーション装置、手ぶれ補正装置に利用できる。具体的には、本発明のジャイロは、ロケットや飛行機などの航空機、自動車やバイクといった移動手段に利用できる。また、本発明のジャイロは超小型で取り扱いが容易であるという利点を生かし、携帯電話や小型のパーソナルコンピュータといった携帯情報端末、玩具、カメラなどに利用できる。

【図面の簡単な説明】

【0094】

【図1】本発明の半導体レーザジャイロに用いられる半導体レーザの一例を模式的に示す斜視図である。

【図2】図1に示した半導体レーザを模式的に示す断面図である。

【図3】図1に示した半導体レーザの活性層の平面形状を模式的に示す図である。

【図4】図1に示した半導体レーザの機能を説明する図である。

【図5】図1に示した半導体レーザの半導体層のバンドギャッププロファイルを模式的に示す図である。

【図6】図1に示した半導体レーザの活性層付近の屈折率を模式的に示す図である。

【図7】第1の電極の一例を模式的に示す平面図である。

【図8】図1に示した半導体レーザから出射されたレーザ光の光強度の角度依存性を示す図である。

【図9】図1に示した半導体レーザから出射された2つのレーザ光によって形成された干渉縞を示す図である。

【図10】本発明の半導体レーザジャイロの一例を模式的に示す（a）全体の斜視図および（b）要部の斜視図である。

【図11】本発明の半導体レーザジャイロの他の一例を模式的に示す（a）全体の斜

視図および (b) 要部の斜視図である。

【図 1 2】本発明の半導体レーザジャイロのその他の一例を模式的に示す (a) 全体の斜視図および (b) 要部の斜視図である。

【図 1 3】図 1 2 に示した半導体レーザジャイロにおけるレーザ光の光路を示す模式図である。

【図 1 4】本発明の半導体レーザジャイロのその他の一例を模式的に示す (a) 全体の斜視図および (b) 要部の斜視図である。

【図 1 5】本発明の半導体レーザジャイロで用いられる半導体レーザの製造工程の一例を模式的に示す斜視図である。

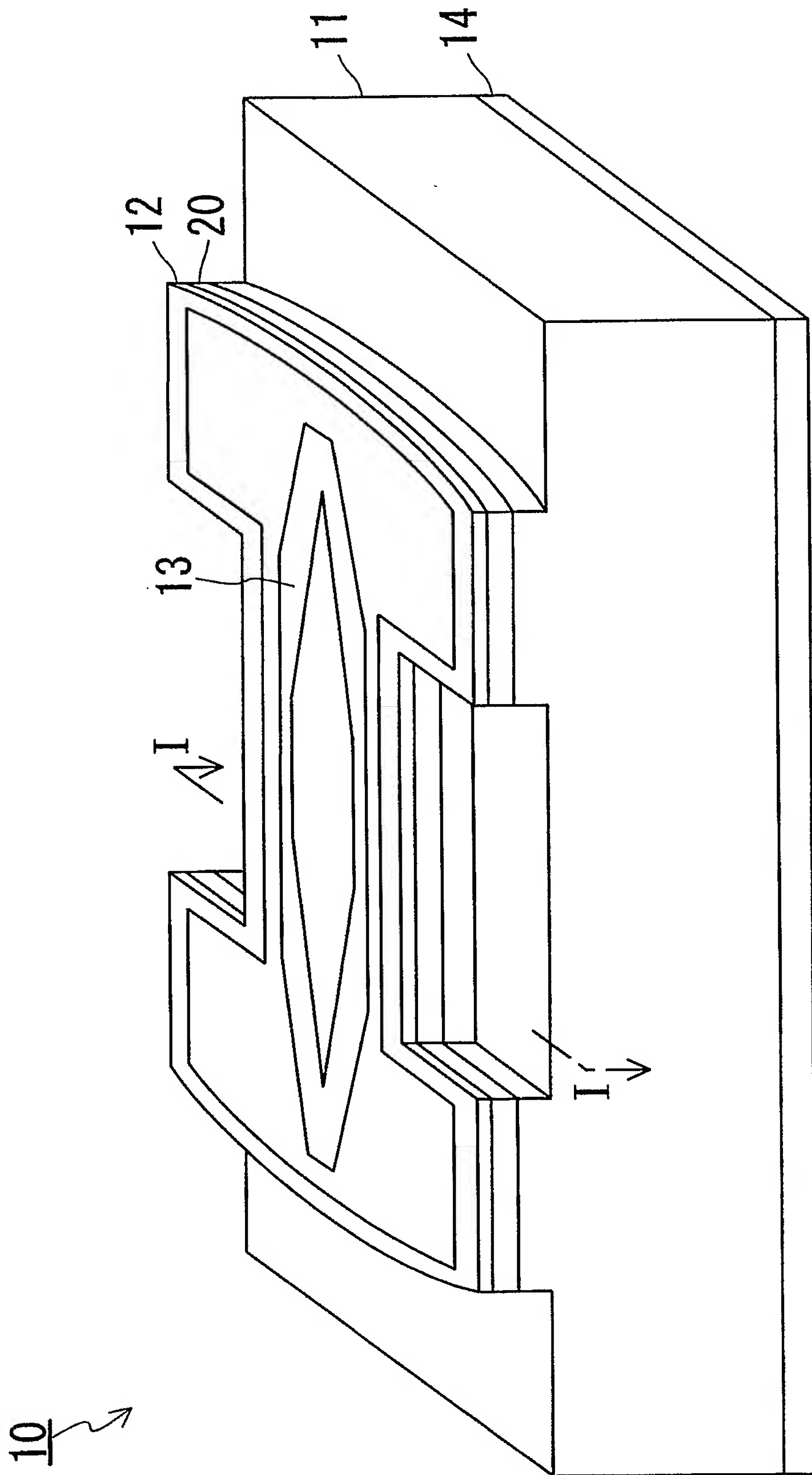
【図 1 6】従来の光ジャイロの構成を模式的に示す図である。

【符号の説明】

【0 0 9 5】

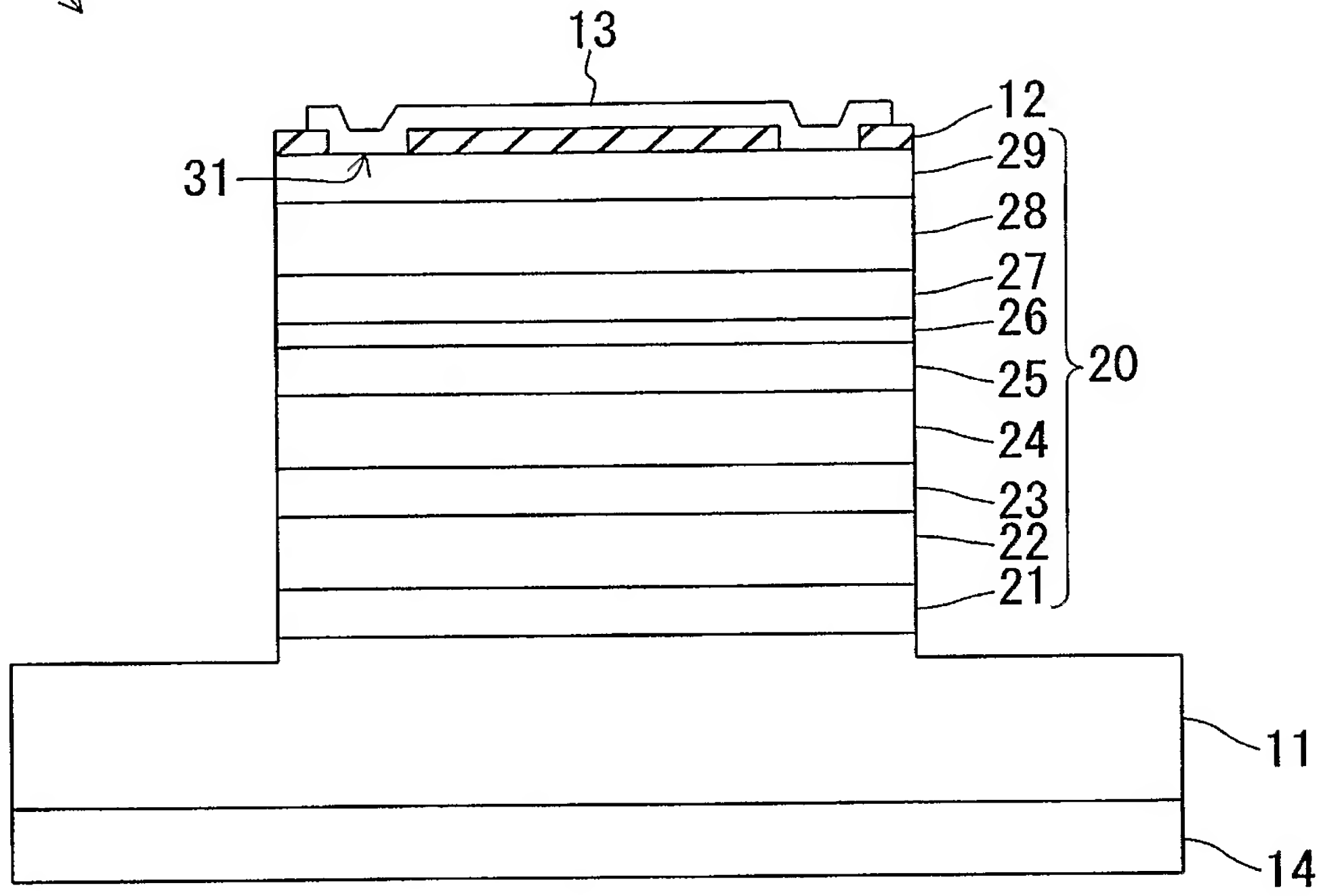
- 1 0 半導体レーザ
- 1 1 基板
- 1 2 絶縁層
- 1 2 h 貫通孔
- 1 3 第 1 の電極
- 1 3 a 第 1 の部分
- 1 3 b 第 2 の部分
- 1 4 第 2 の電極
- 2 0 半導体層
- 2 1 バッファ層
- 2 2 バッファ層
- 2 3 グレーデッド層
- 2 4 クラッド層
- 2 5 グレーデッド層
- 2 6 活性層
- 2 6 a ~ 2 6 d (第 1 から第 4 の) 端面
- 2 7 グレーデッド層
- 2 8 クラッド層
- 2 9 キャップ層
- 3 1、3 1 a、3 1 b 第 2 の領域
- 3 2 菱形の経路
- 3 2 a ~ 3 2 d (第 1 から第 4 の) 角部
- 3 5 第 1 のレーザ光
- 3 6 第 2 のレーザ光
- 1 0 1 ~ 1 0 4 半導体レーザジャイロ
- 1 1 1 カバー
- 1 1 2 ステム
- 1 1 3、1 1 6 光検出器
- 1 1 3 a、1 1 3 b、1 1 6 a、1 1 6 b 受光素子
- 1 1 4 電極
- 1 1 5 球面レンズ
- 1 1 7 プリズム
- 1 5 1、1 5 2 レジスト膜
- L 1、L 2 レーザ光

【書類名】 図面
【図 1】

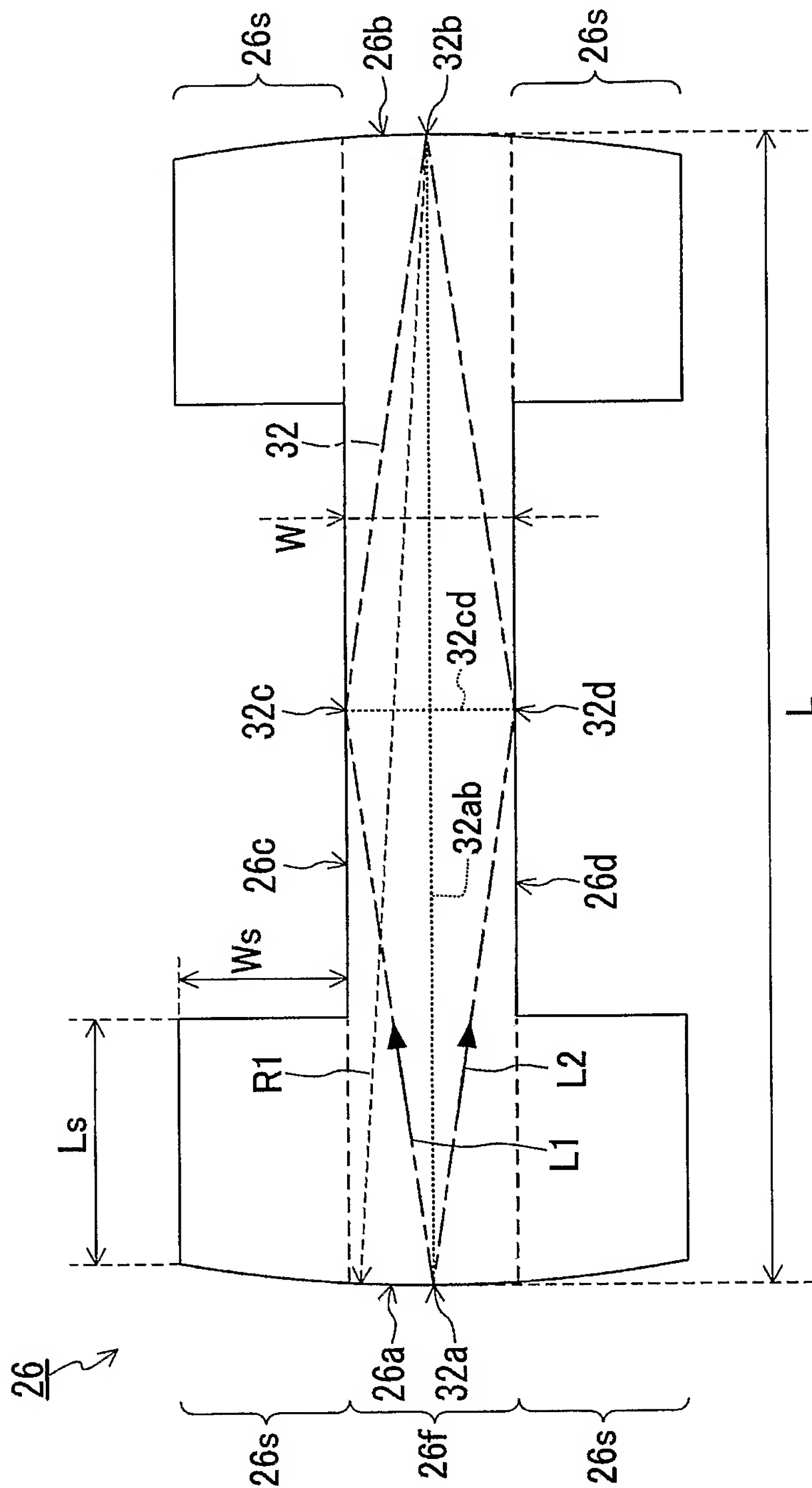


【図 2】

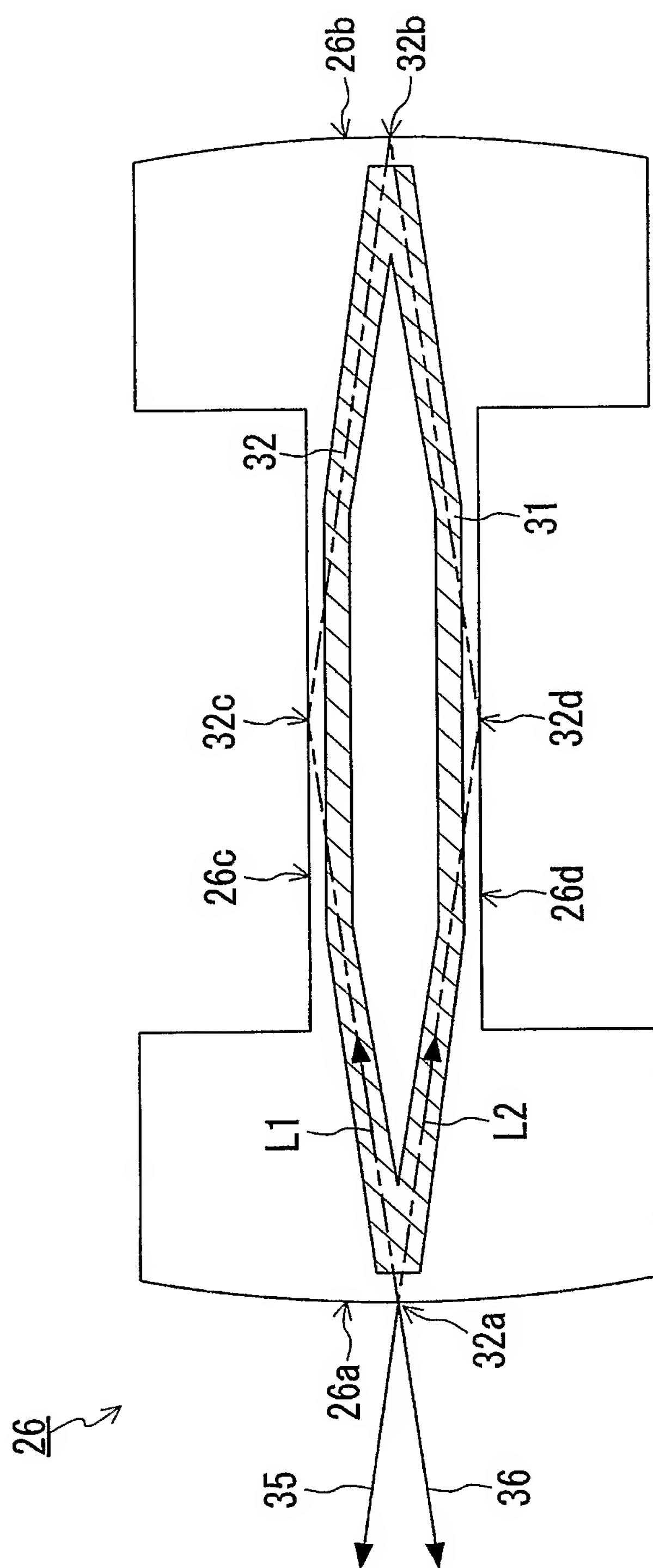
10
↓



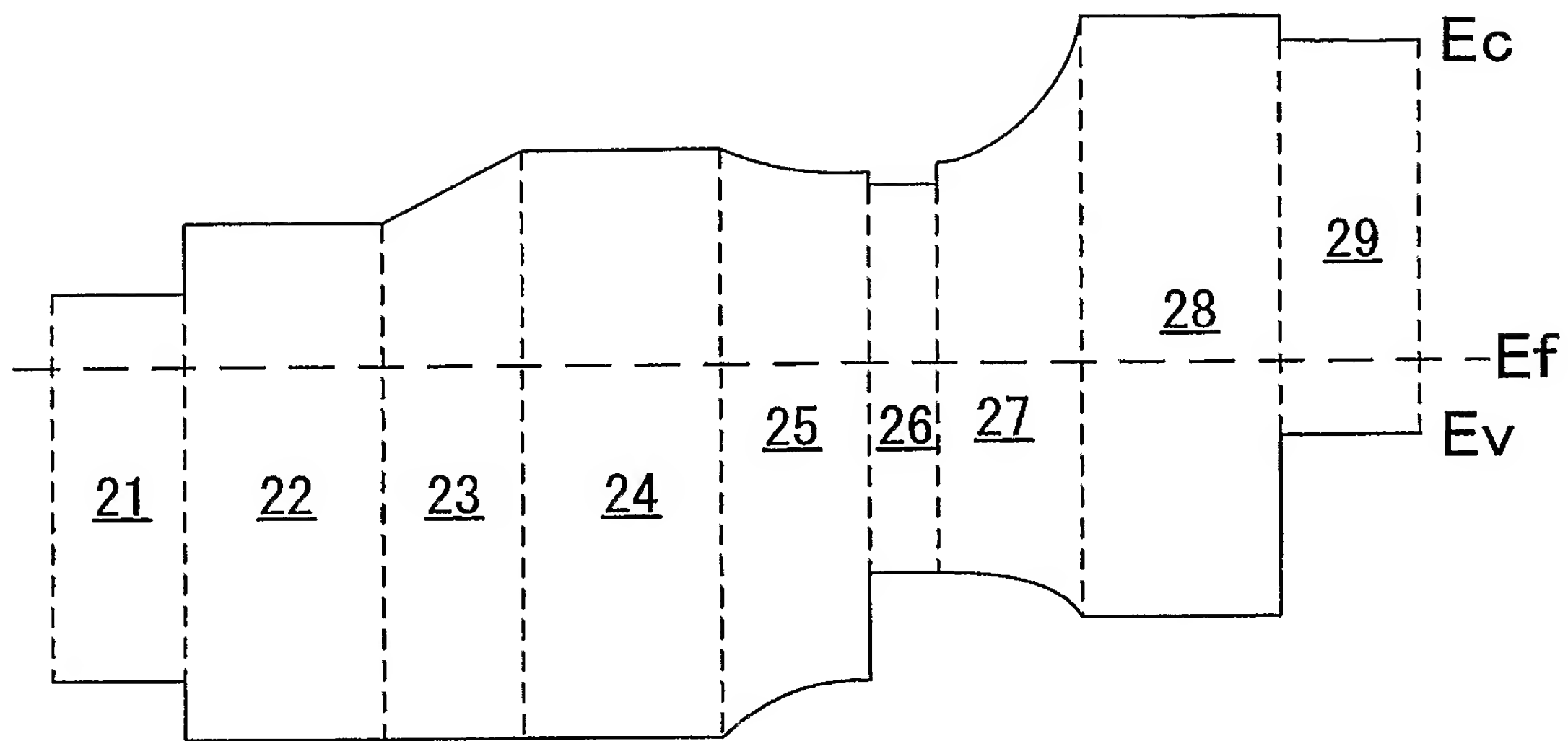
【図 3】



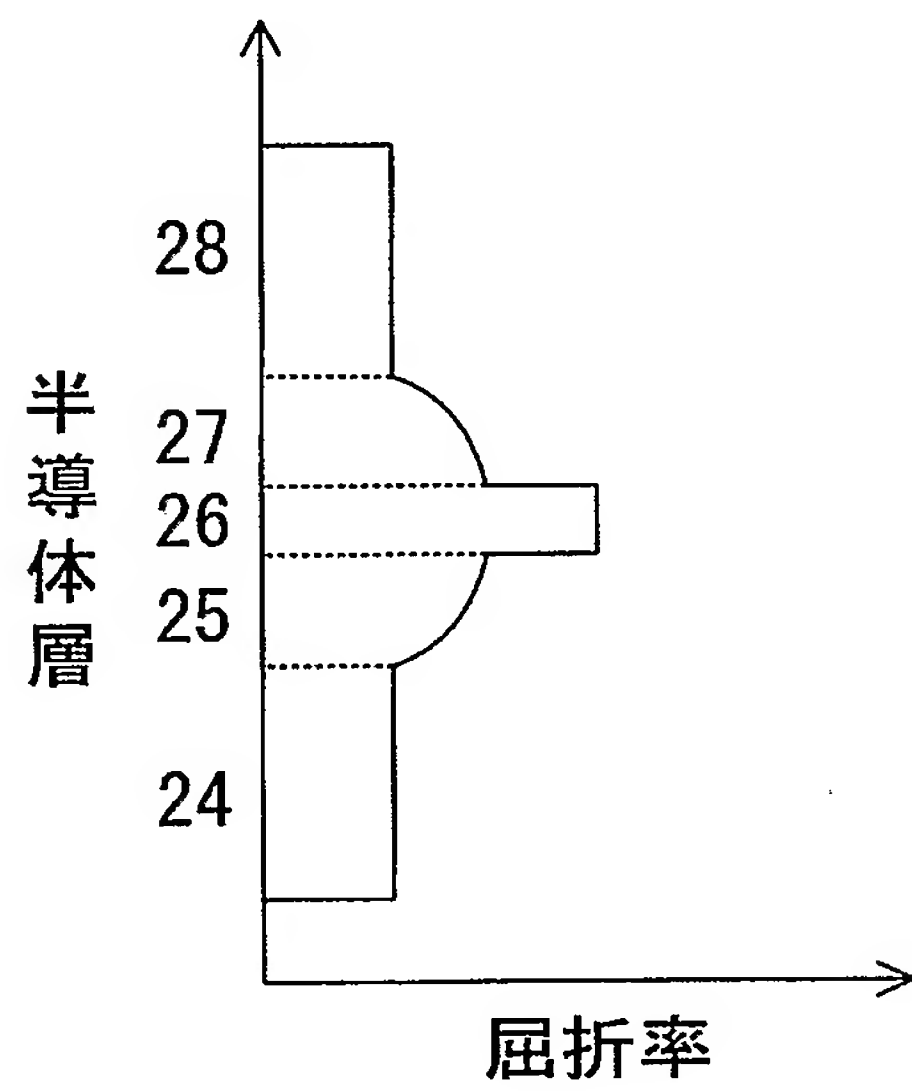
【図 4】



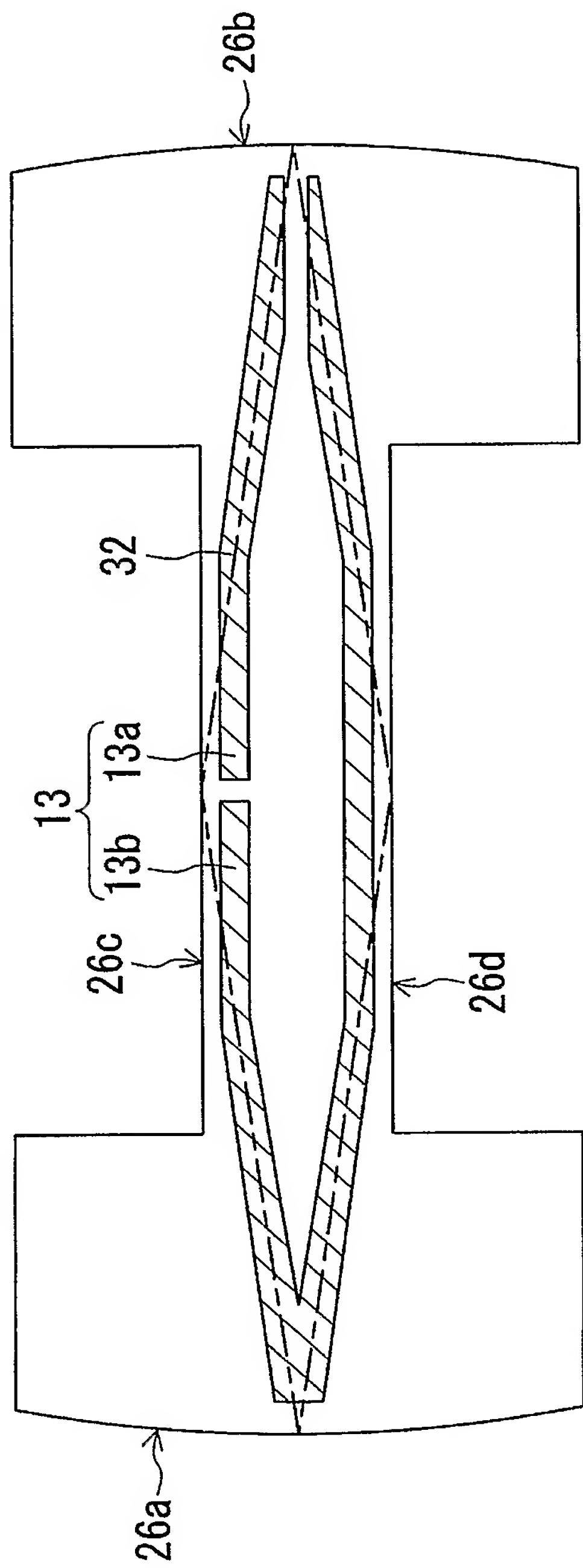
【図 5】



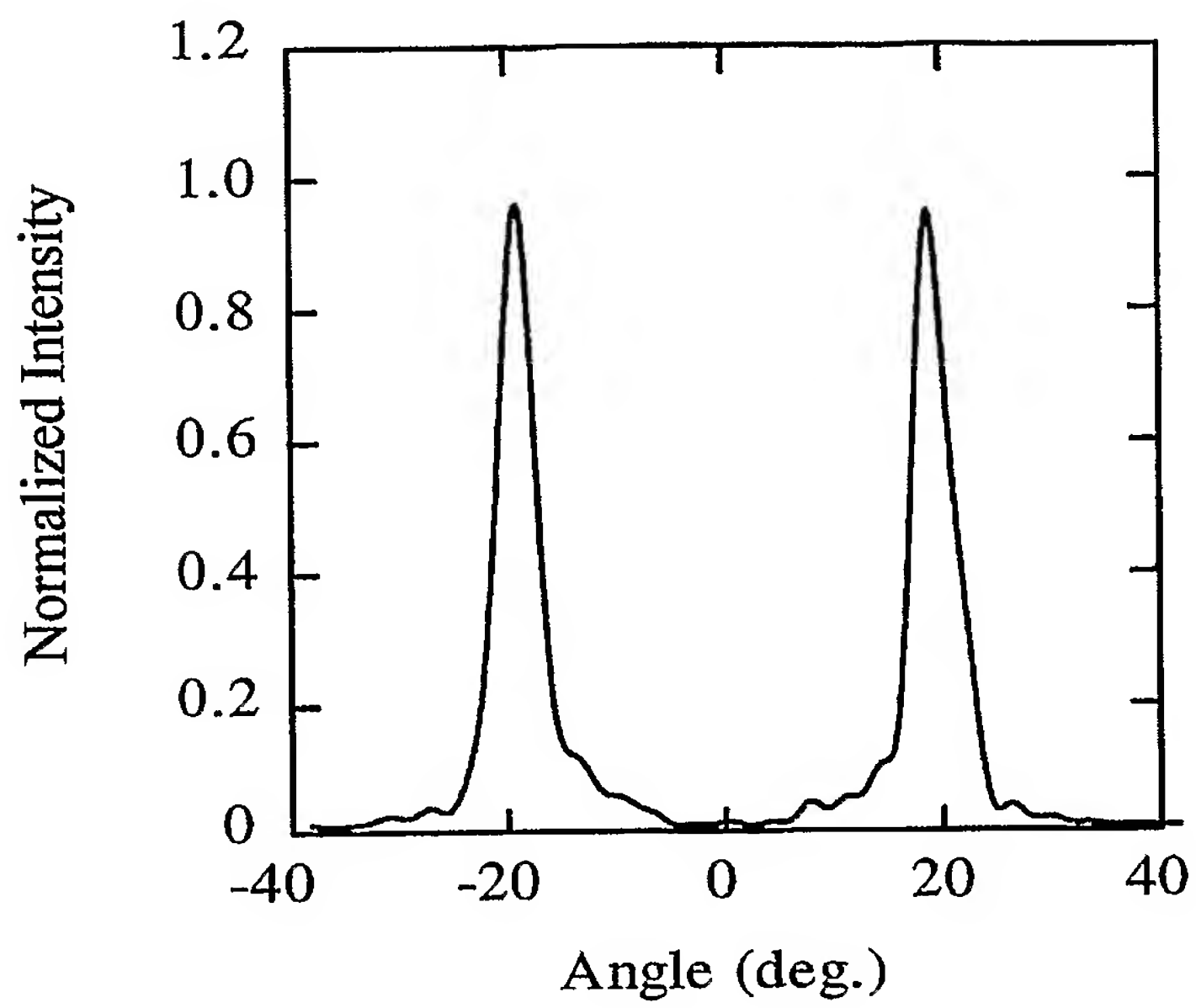
【図 6】



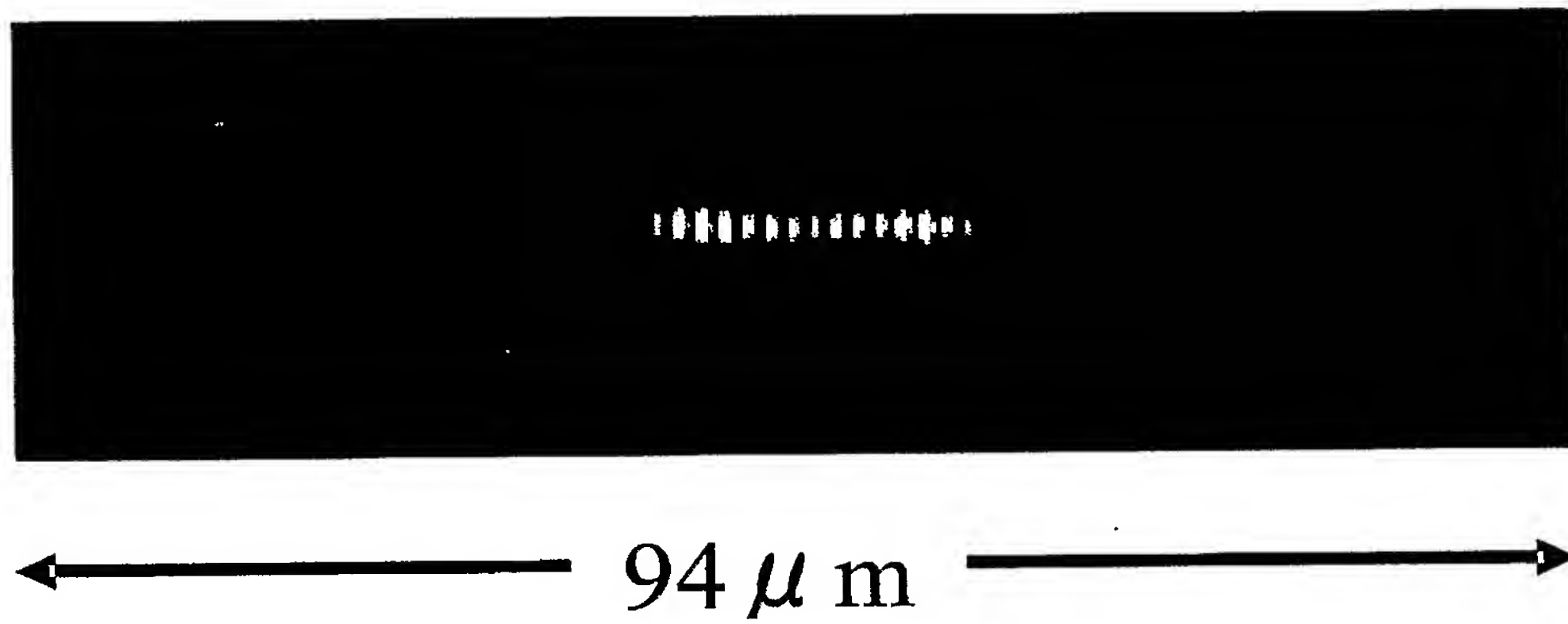
【図 7】



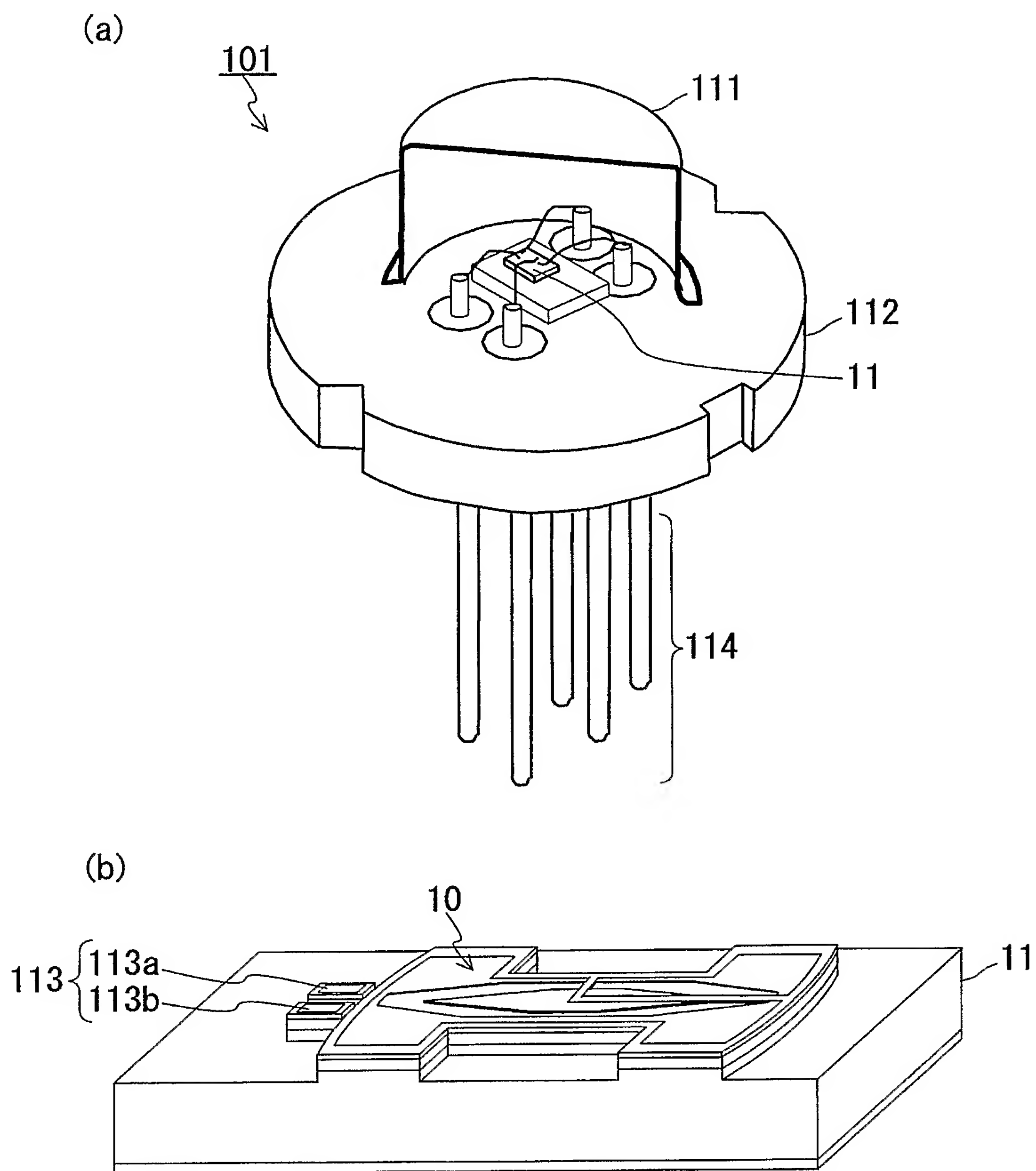
【図 8】



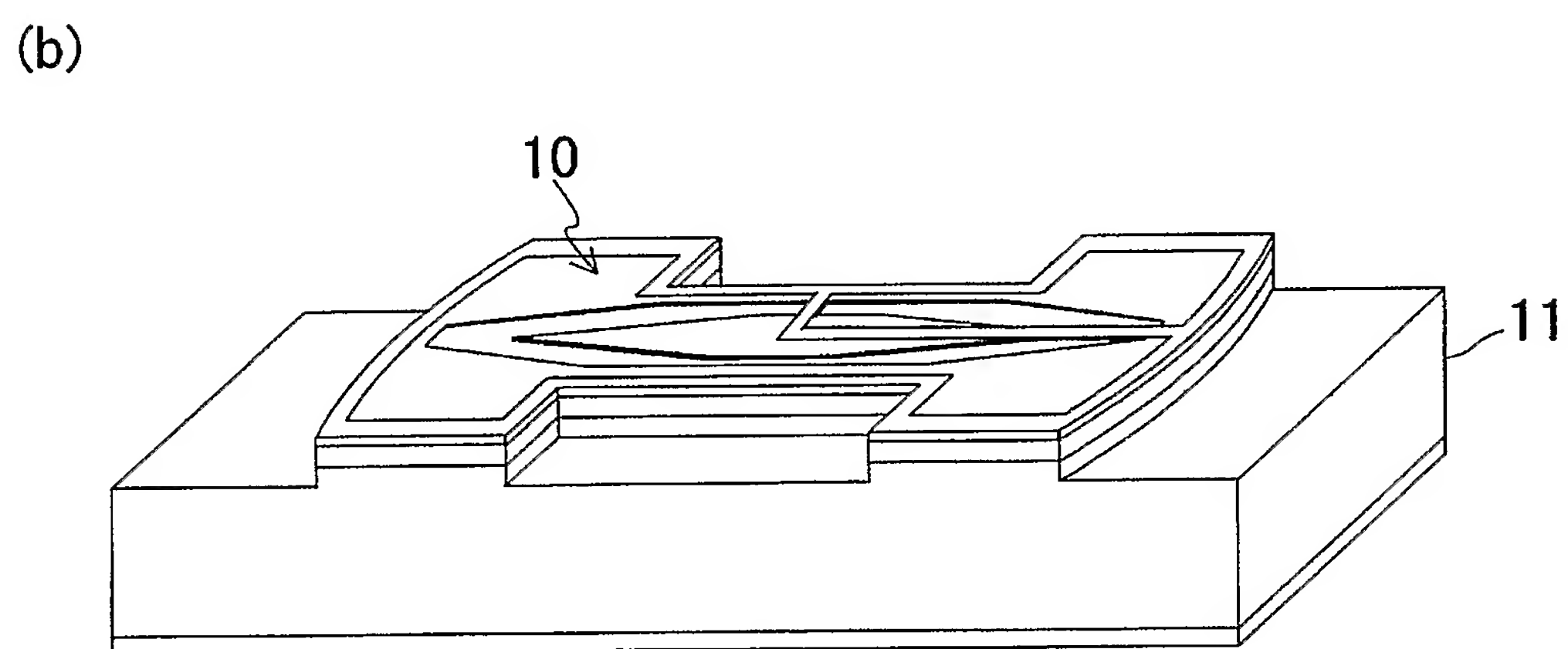
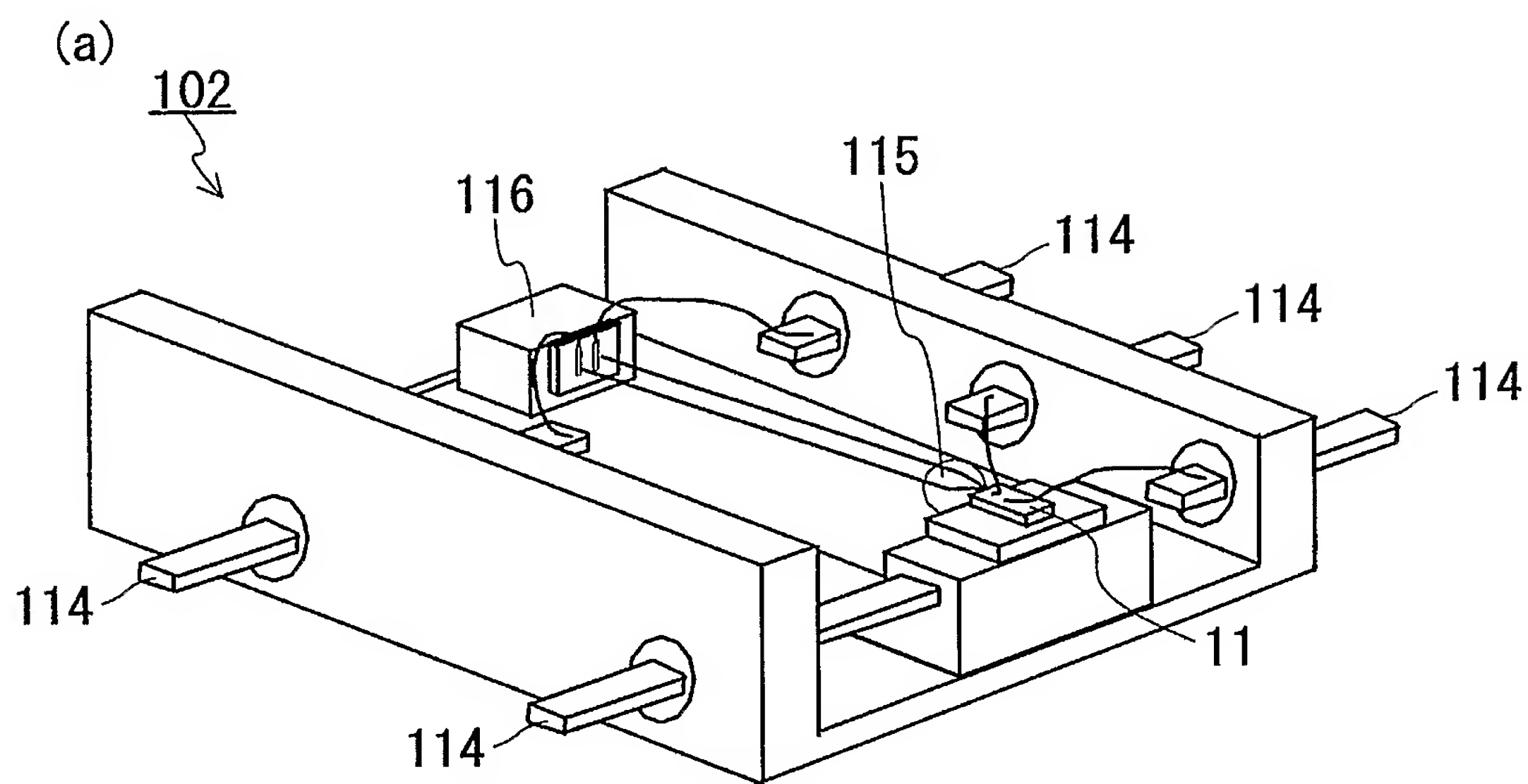
【図 9】



【図 10】

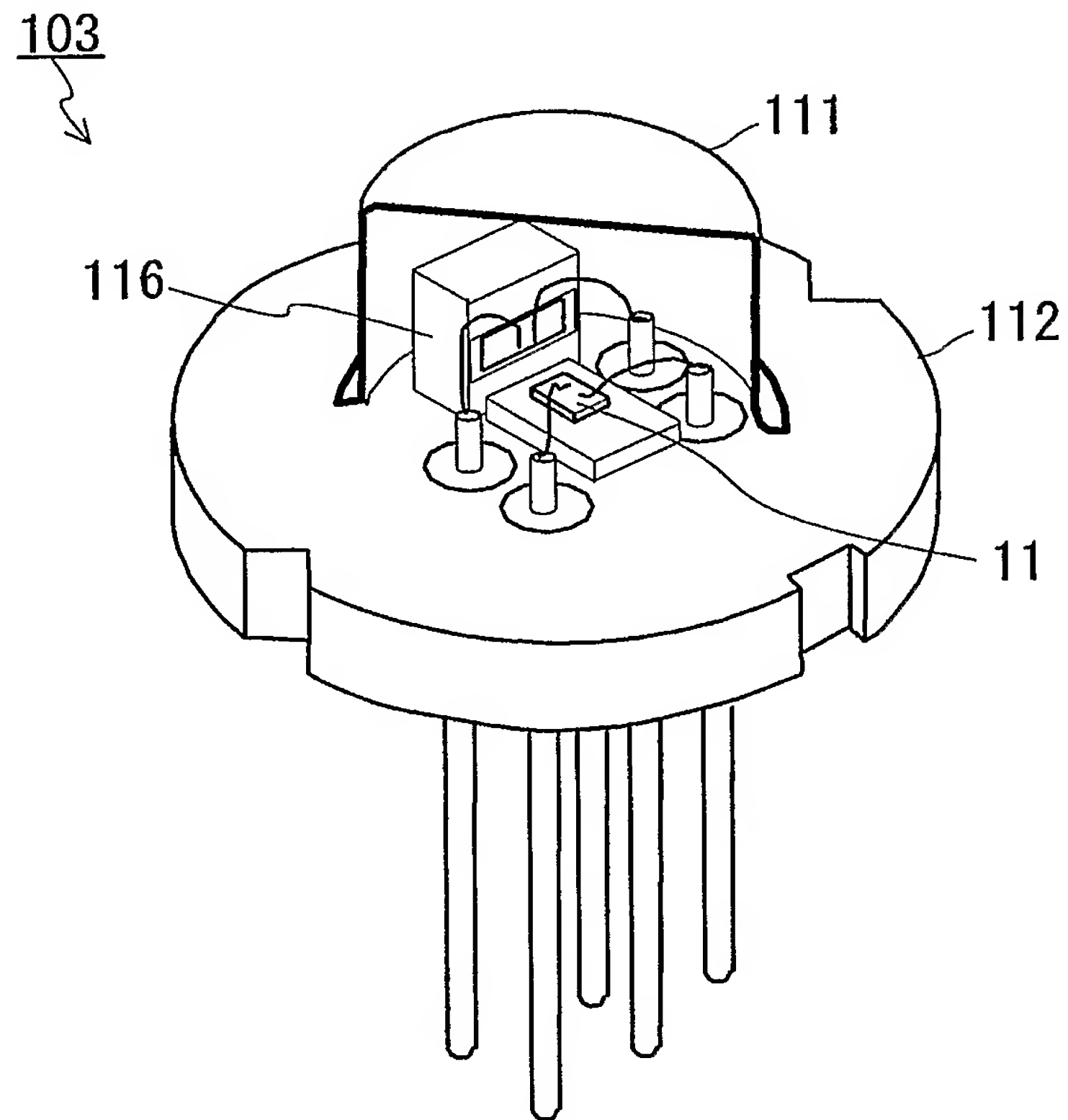


【図 11】

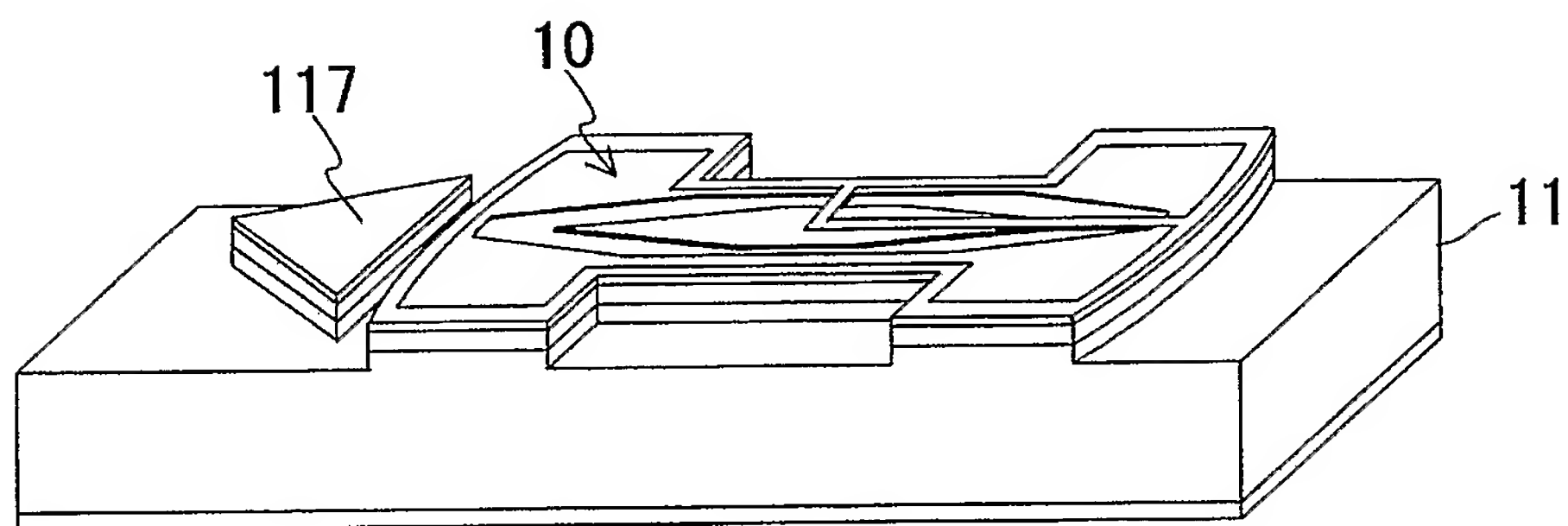


【図 12】

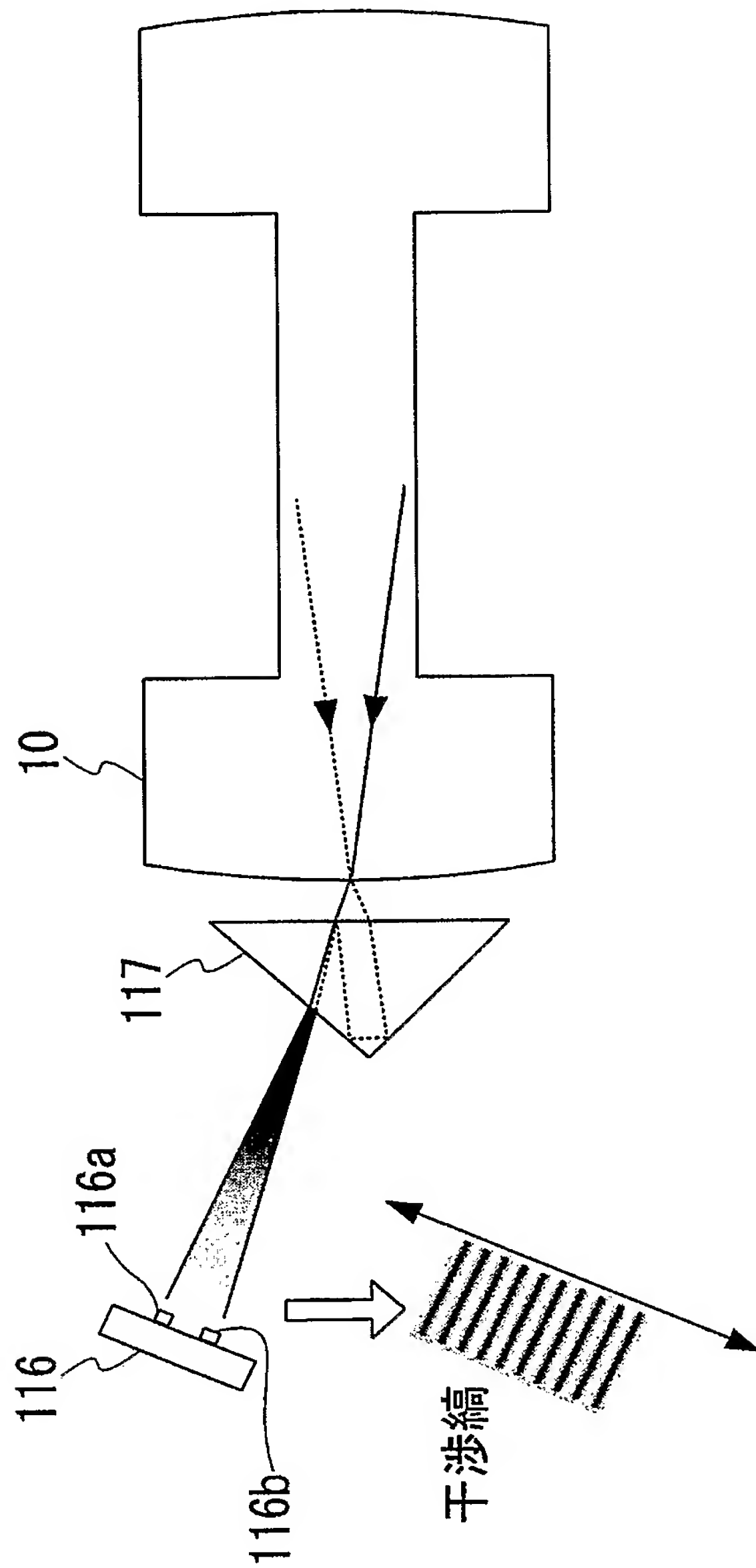
(a)



(b)

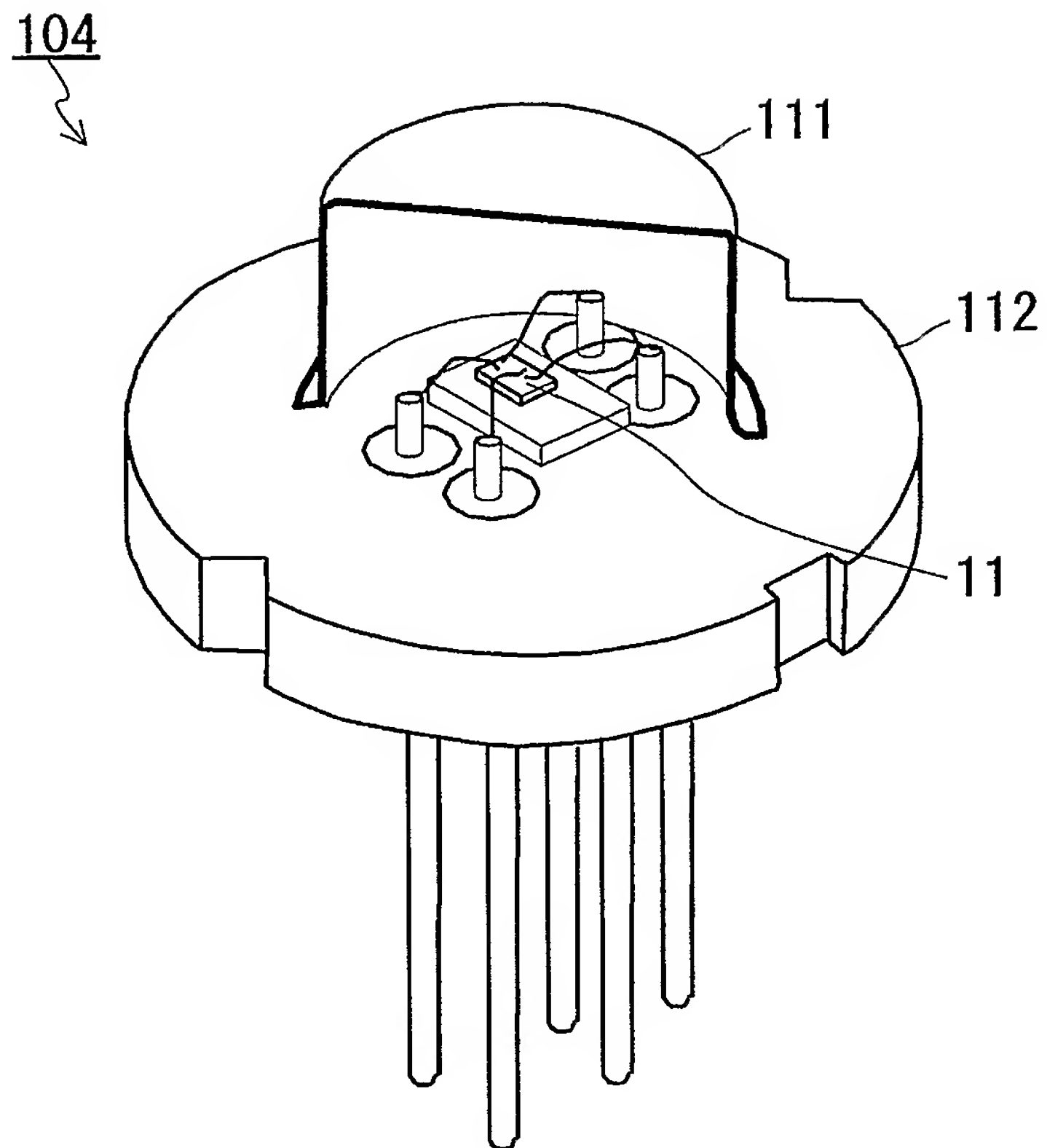


【図 13】

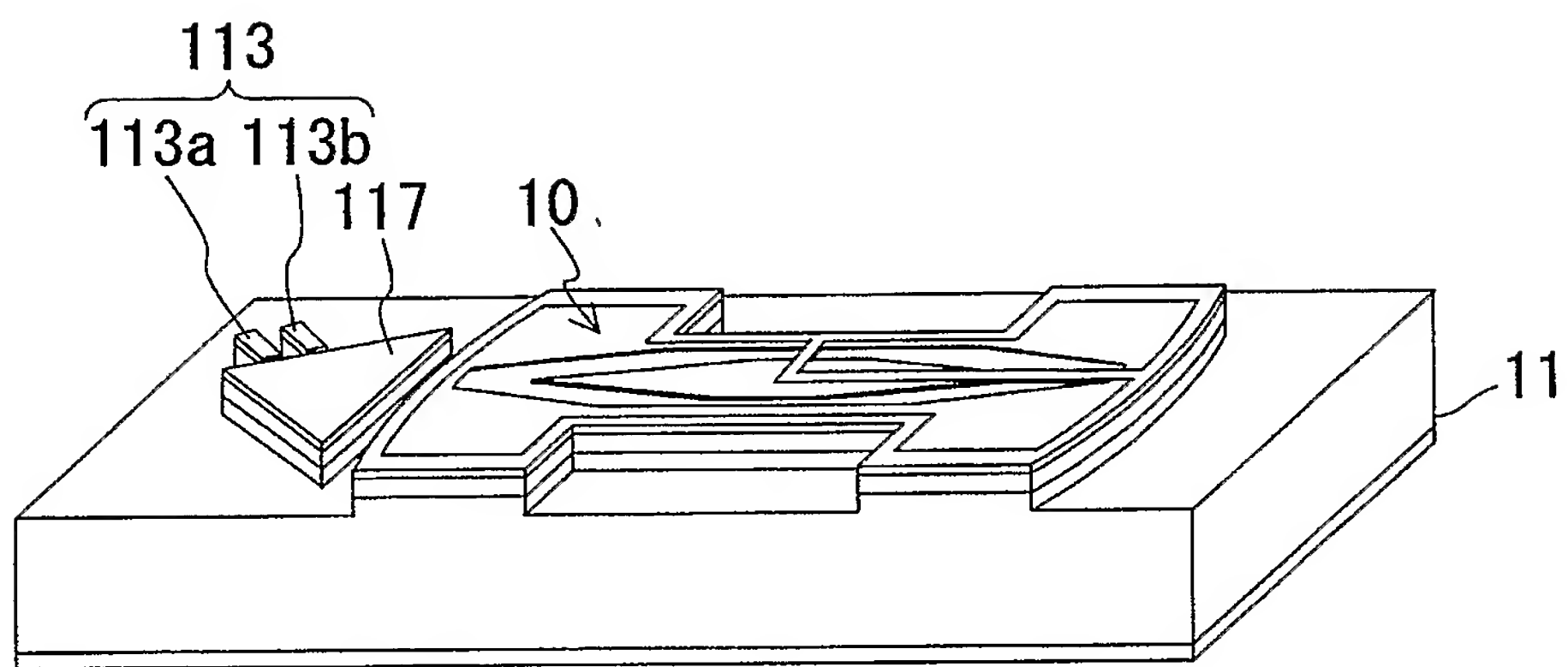


【図 14】

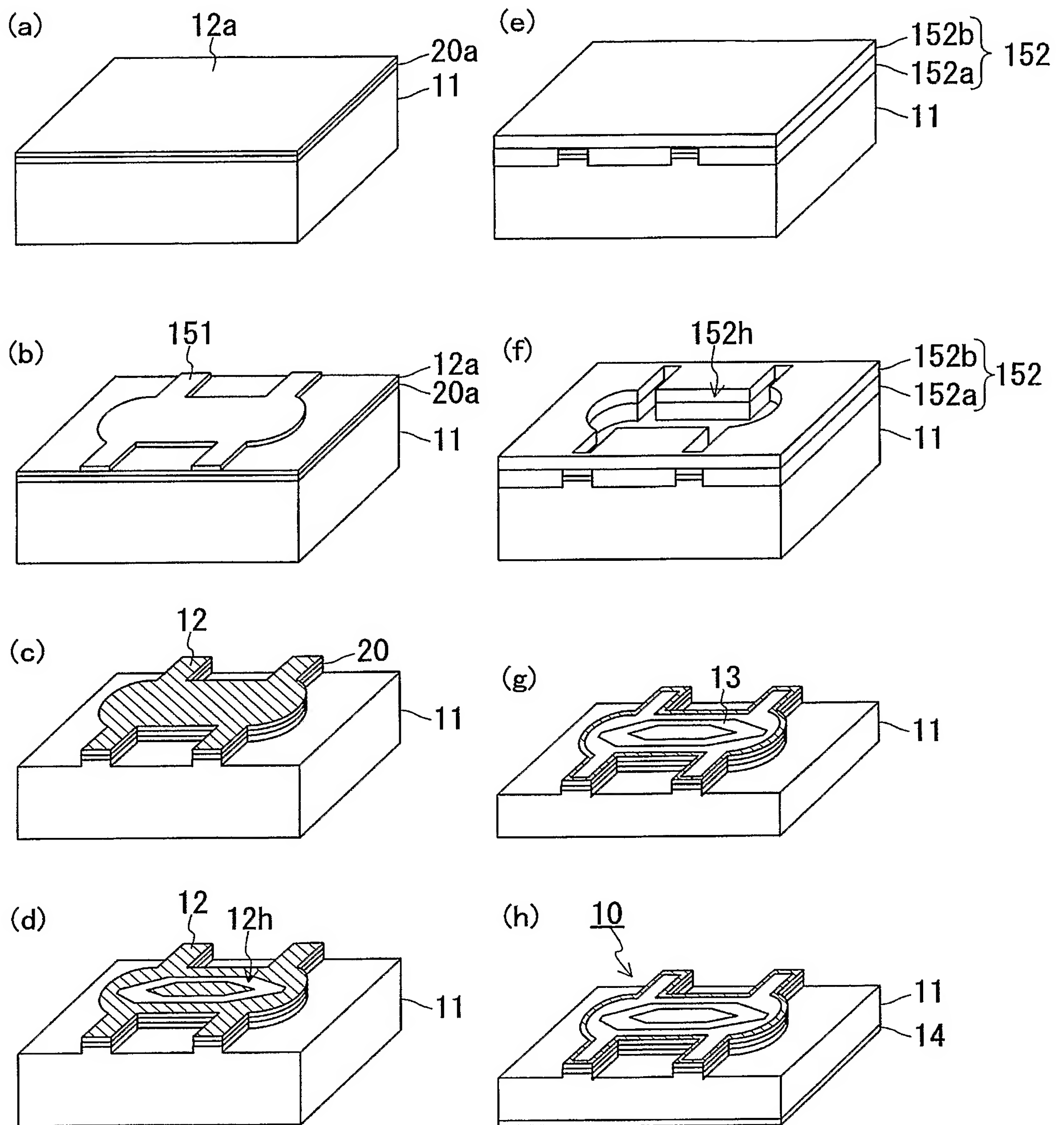
(a)



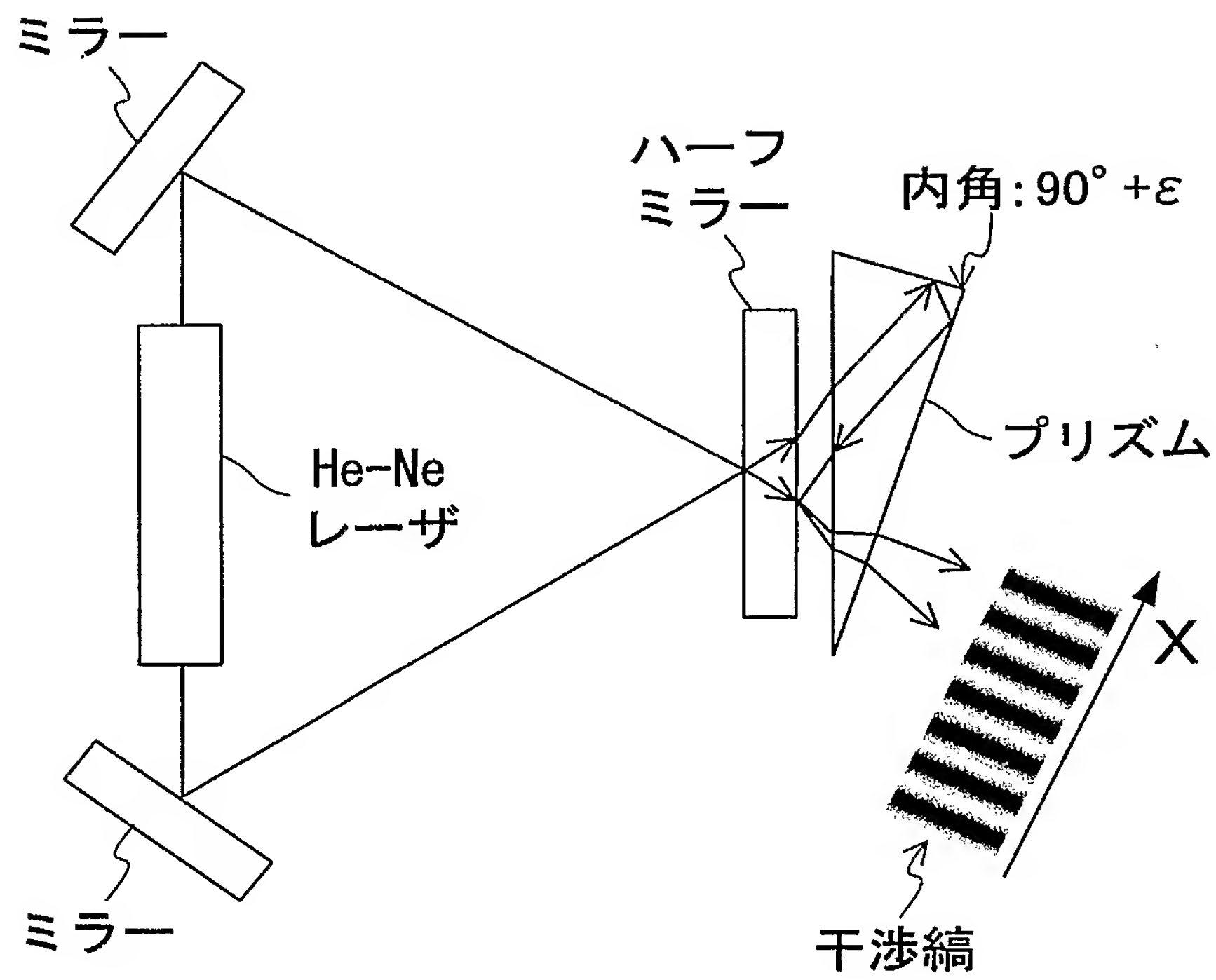
(b)



【図 15】



【図 16】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 新規な構造の半導体レーザを用いることによって、半導体レーザを用いた従来のジャイロよりも精度よく簡単に回転を検出できる半導体レーザジャイロを提供する。

【解決手段】 第 1 および第 2 のレーザ光を出射する半導体レーザ 1 0 と光検出器とを備える半導体レーザジャイロであって、光検出器は、前記第 1 および第 2 のレーザ光によって干渉縞が形成される位置に配置されている。半導体レーザ 1 0 は、活性層と活性層にキャリアを注入するための第 1 および第 2 の電極 1 3 および 1 4 とを備える。第 1 のレーザ光は、活性層内において多角形の経路上を周回するレーザ光（L 1）の一部が出射されたレーザ光であり、第 2 のレーザ光は、上記経路上をレーザ光（L 1）とは逆の方向に周回するレーザ光（L 2）の一部が出射されたレーザ光である。

【選択図】 図 1

特願 2 0 0 4 - 0 5 9 4 0 2

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [3 9 3 0 3 1 5 8 6]

1. 変更年月日	2 0 0 0 年 3 月 2 7 日
[変更理由]	住所変更
住 所	京都府相楽郡精華町光台二丁目 2 番地 2
氏 名	株式会社国際電気通信基礎技術研究所

特願 2 0 0 4 - 0 5 9 4 0 2

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[5 9 1 0 6 0 9 8 0]

1. 変更年月日

1 9 9 1 年 3 月 2 7 日

[変更理由]

新規登録

住 所

岡山県岡山市内山下 2 丁目 4 番 6 号

氏 名

岡山県